

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4236716号
(P4236716)

(45) 発行日 平成21年3月11日 (2009. 3. 11)

(24) 登録日 平成20年12月26日 (2008. 12. 26)

(51) Int. Cl.

F I

H O 1 L 29/786 (2006. 01)

H O 1 L 21/336 (2006. 01)

H O 1 L 29/78 6 1 6 U

H O 1 L 29/78 6 1 3 A

H O 1 L 29/78 6 1 7 A

H O 1 L 29/78 6 1 6 A

H O 1 L 29/78 6 1 8 C

請求項の数 2 (全 38 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-282562
 (22) 出願日 平成9年9月29日 (1997. 9. 29)
 (65) 公開番号 特開平11-103068
 (43) 公開日 平成11年4月13日 (1999. 4. 13)
 審査請求日 平成16年7月26日 (2004. 7. 26)

(73) 特許権者 000153878
 株式会社半導体エネルギー研究所
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
 (72) 発明者 山崎 舜平
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 小山 潤
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 福永 健司
 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内

審査官 河本 充雄

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁表面上に形成された第1のゲイト電極と、前記第1のゲイト電極を覆って形成されたゲイト絶縁膜と、前記ゲイト絶縁膜上に前記第1のゲイト電極を覆って形成された第1の結晶性珪素膜と、前記第1の結晶性珪素膜上に形成された第1の導電層、第2の導電層、第1のソース電極の順に積層された第1の積層構造、及び第3の導電層、第4の導電層、第1のドレイン電極の順に積層された第2の積層構造と、を有するNチャネル型薄膜トランジスタと、

前記絶縁表面上に形成された第2のゲイト電極と、前記第2のゲイト電極を覆って形成された前記ゲイト絶縁膜と、前記ゲイト絶縁膜上に前記第2のゲイト電極を覆って形成された第2の結晶性珪素膜と、前記第2の結晶性珪素膜上に形成された第5の導電層、第6の導電層、第2のドレイン電極の順に積層された第3の積層構造、及び第7の導電層、第8の導電層、第2のソース電極の順に積層された第4の積層構造と、を有するPチャネル型薄膜トランジスタと、を有する半導体装置であって、

前記第1の積層構造は前記第1のゲイト電極と重なっており、前記第2の積層構造は前記第1のゲイト電極と重なっておらず、

前記第3の積層構造は前記第2のゲイト電極と重なっておらず、前記第4の積層構造は前記第2のゲイト電極と重なっており、

前記第1の結晶性珪素膜は、前記第1の積層構造と重なっている第1の領域と、前記第2の積層構造と重なっている第2の領域と、前記第1の積層構造及び前記第2の積層構造

10

20

と重なっていない第3の領域と、を有し、

前記第2の結晶性珪素膜は、前記第3の積層構造と重なっている第4の領域と、前記第4の積層構造と重なっている第5の領域と、前記第3の積層構造及び前記第4の積層構造と重なっていない第6の領域と、を有し、

前記第1の結晶性珪素膜、前記第2の結晶性珪素膜、前記第1の導電層、前記第2の導電層、前記第3の導電層、前記第4の導電層は、前記第5の導電層、前記第6の導電層、前記第7の導電層及び前記第8の導電層は、珪素の結晶化を助長するN iを用いて結晶化された結晶性珪素膜からなり、

前記第1の導電層、前記第2の導電層、前記第3の導電層及び前記第4の導電層は、N型不純物元素が添加されており、

10

前記第5の導電層、前記第6の導電層、前記第7の導電層及び前記第8の導電層は、P型不純物元素が添加されており、

前記第1の領域及び前記第2の領域の膜厚は、前記第3の領域の膜厚より厚く、

前記第4の領域及び前記第5の領域の膜厚は、前記第6の領域の膜厚より厚く、

前記第2の導電層に含まれるN型不純物元素の濃度は、前記第1の導電層に含まれるN型不純物元素の濃度より高く、かつ前記第1の領域に含まれる導電性を付与する不純物元素の濃度より高く、

前記第4の導電層に含まれるN型不純物元素の濃度は、前記第3の導電層に含まれるN型不純物元素の濃度より高く、かつ前記第2の領域に含まれるN型不純物元素の濃度より高く、

20

前記第6の導電層に含まれるP型不純物元素の濃度は、前記第5の導電層に含まれるP型不純物元素の濃度より高く、かつ前記第4の領域に含まれる導電性を付与する不純物元素の濃度より高く、

前記第8の導電層に含まれるP型不純物元素の濃度は、前記第7の導電層に含まれるP型不純物元素の濃度より高く、かつ前記第5の領域に含まれるP型不純物元素の濃度より高く、

前記第1の導電層、前記第2の導電層、前記第3の導電層及び前記第4の導電層は、前記第1の結晶性珪素膜から移動した、前記珪素の結晶化を助長するN iを含み、

前記第5の導電層、前記第6の導電層、前記第7の導電層及び前記第8の導電層は、前記第2の結晶性珪素膜から移動した、前記珪素の結晶化を助長するN iを含み、

30

前記第3の領域のうち、前記第1のゲイト電極と重なっていない領域は、オフセット領域として機能し、

前記第6の領域のうち、前記第2のゲイト電極と重なっていない領域は、オフセット領域として機能することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記第1の導電層の膜厚は、前記第1の領域の膜厚より薄く、かつ前記第2の導電層の膜厚より厚く、

前記第3の導電層の膜厚は、前記第2の領域の膜厚より薄く、かつ前記第4の導電層の膜厚より厚く、

40

前記第5の導電層の膜厚は、前記第4の領域の膜厚より薄く、かつ前記第6の導電層の膜厚より厚く、

前記第7の導電層の膜厚は、前記第5の領域の膜厚より薄く、かつ前記第8の導電層の膜厚より厚いことを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】

本願発明は結晶構造を有する半導体薄膜を利用した半導体装置およびその作製方法に関する。特に、逆スタガ構造の薄膜トランジスタ（以下、T F Tと略記する）の構成に関する。また、上記T F Tを用いた半導体回路、電気光学装置及び電子機器の構成に関する。

50

【 0 0 0 2 】

なお、本明細書中において「半導体装置」とは半導体特性を利用して機能しうる装置全てを指しており、本明細書中に記載されたTFT、半導体回路、電気光学装置及び電子機器は全て半導体装置の範疇に含まれるものとする。

【 0 0 0 3 】

【従来の技術】

従来より、アクティブマトリクス型液晶表示装置（以下、AMLCDと略記する）のスイッチング素子としてTFTが利用されている。現在では非晶質珪素膜（アモルファスシリコン膜）を活性層として利用したTFTで回路構成を行う製品が市場を占めている。特に、TFT構造としては製造工程の簡単な逆スタガ構造が多く採用されている。

10

【 0 0 0 4 】

しかし、年々AMLCDの高性能化が進み、TFTに求められる動作性能（特に動作速度）は厳しくなる傾向にある。そのため、非晶質珪素膜を用いたTFTの動作速度では十分な性能を有する素子を得ることが困難となった。

【 0 0 0 5 】

そこで、非晶質珪素膜に代わって多結晶珪素膜（ポリシリコン膜）を利用したTFTが脚光を浴び、多結晶珪素膜を活性層とするTFTの開発が著しい勢いで進んできている。現在では、その一部で製品化も行われている。

【 0 0 0 6 】

活性層として多結晶珪素膜を利用した逆スタガ型TFTの構造については既に多くの発表がなされている。例えば、「Fabrication of Low-Temperature Bottom-Gate Poly-Si TFTs on Large-Area Substrate by Linear-Beam Excimer Laser Crystallization and Ion Doping Method: H. Hayashi et.al., IEDM95, PP829-832, 1995」などの報告がある。

20

【 0 0 0 7 】

同報告書では多結晶珪素膜を利用した逆スタガ構造の典型的な例（Fig.4）を説明しているが、このような構造の逆スタガ構造（いわゆるチャネルストップ型）では様々な問題も抱えている。

【 0 0 0 8 】

まず、活性層全体が50nm程度と極めて薄いのでチャネル形成領域とドレイン領域との接合部において衝突電離（Impact Ionization）が発生し、ホットキャリア注入などの劣化現象が顕著に現れてしまう。そのため、大きなLDD領域（Light Doped Drain region）を形成する必要性が生じる。

30

【 0 0 0 9 】

そして、このLDD領域の制御性が最も重大な問題となる。LDD領域は不純物濃度と領域の長さの制御が非常に微妙であり、特に長さ制御が問題となる。現状ではマスクパターンによってLDD領域の長さを規定する方式が採られているが、微細化が進めば僅かなパターンニング誤差が大きなTFT特性の差を生む。

【 0 0 1 0 】

活性層の膜厚のバラツキによるLDD領域のシート抵抗のバラツキも深刻な問題となる。さらに、ゲイト電極のテーパ角度等のバラツキもLDD領域の効果のバラツキを招く要因となりうる。

40

【 0 0 1 1 】

また、LDD領域を形成するためにはパターンニング工程が必要であり、それはそのまま製造工程の増加、スループットの低下を招く。上記報告書に記載された逆スタガ構造では最低でもマスク6枚（ソース/ドレイン電極形成まで）が必要であると予想される。

【 0 0 1 2 】

以上の様に、チャネルストップ型の逆スタガ構造ではチャネル形成領の両側に横方向の平面内でLDD領域を形成しなくてはならず、再現性のあるLDD領域を形成することは非常に困難である。

【 0 0 1 3 】

50

【本発明が解決しようとする課題】

本願発明では、非常に簡易な製造工程によって、量産性が高く、且つ、信頼性及び再現性の高い半導体装置を作製する技術を提供することを課題とする。

【0014】**【課題を解決するための手段】**

本明細書で開示する発明の構成は、

結晶構造を有する半導体層で構成されたソース領域、ドレイン領域及びチャネル形成領域を構成に含む半導体装置であって、

前記ソース領域及びドレイン領域は、ゲイト絶縁膜に向かって少なくとも第1の導電層、当該第1の導電層よりも高抵抗な第2の導電層及び前記チャネル形成領域と同一導電型の半導体層からなる積層構造を有することを特徴とする。

10

【0015】

また、他の発明の構成は、

上記構成において、前記第1の導電層から前記第2の導電層にかけて当該第1及び第2の導電層を構成する不純物の濃度プロファイルが連続的に変化していることを特徴とする。

【0016】

また、他の発明の構成は、

上記構成において、前記第2の導電層は $5 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ の範囲内で連続的に変化する不純物によって形成されていることを特徴とする。

20

【0017】

また、他の発明の構成は、

上記構成において、前記チャネル形成領域と前記第2の導電層との間には、膜厚の異なる二つのオフセット領域が存在することを特徴とする。

【0018】

また、他の発明の構成は、

上記構成において、前記チャネル形成領域と前記第2の導電層との間には、前記チャネル形成領域よりも膜厚の厚いオフセット領域が存在することを特徴とする。

【0019】

また、他の発明の構成は、

絶縁表面を有する基板上に形成されたゲイト電極と、

30

結晶構造を有する半導体層で構成されたソース領域、ドレイン領域及びチャネル形成領域と、

前記ソース領域及びドレイン領域上のそれぞれに形成されたソース電極及びドレイン電極と、

を構成に含む半導体装置であって、

前記ソース領域及びドレイン領域は、少なくともゲイト絶縁膜に向かって第1の導電層、当該第1の導電層よりも高抵抗な第2の導電層及び前記チャネル形成領域と同一導電型の半導体層からなる積層構造を有し、

前記ソース電極及び/又はドレイン電極は前記ゲイト電極に、前記チャネル形成領域上でオーバーラップしていることを特徴とする。

40

【0020】

また、他の発明の構成は、

結晶構造を有する半導体層で構成されたソース領域、ドレイン領域及びチャネル形成領域を構成に含む半導体装置であって、

前記ソース領域及びドレイン領域は、少なくともゲイト絶縁膜に向かって第1の導電層、当該第1の導電層よりも高抵抗な第2の導電層及び前記チャネル形成領域と同一導電型の半導体層からなる積層構造を有し、

前記チャネル形成領域と前記第1の導電層との間には、膜厚の異なる二つのオフセット領域と前記第2の導電層からなるHRD構造が存在することを特徴とする。

【0021】

50

なお、前記膜厚の異なる二つのオフセット領域は、一方は前記チャネル形成領域と同一導電型かつ同一膜厚の半導体層からなる膜面方向のオフセットであり、他方は前記チャネルと同一導電型かつ前記チャネル形成領域よりも膜厚の厚い半導体層からなる膜厚方向のオフセットであることを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

また、作製方法に関する他の発明の構成は、
絶縁表面を有する基板上にゲイト電極、ゲイト絶縁層、非晶質半導体膜を形成する工程と、
前記非晶質半導体膜に対して結晶化を助長する触媒元素を添加し、加熱処理により結晶構造を有する半導体膜を得る工程と、
前記結晶構造を有する半導体膜に対して 1 5 族のみ或いは 1 3 族及び 1 5 族から選ばれた不純物を添加する工程と、
加熱処理により前記不純物を含む導電層に対して前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
前記導電層上にソース電極及びドレイン電極を形成する工程と、
前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして前記結晶構造を有する半導体膜をエッチングすることでチャネル形成領域を形成する工程と、
を構成に含むことを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

また、他の発明の構成は、
絶縁表面を有する基板上にゲイト電極、ゲイト絶縁層、非晶質半導体膜を形成する工程と、
前記非晶質半導体膜に対して結晶化を助長する触媒元素を添加し、加熱処理により結晶構造を有する半導体膜を得る工程と、
前記結晶構造を有する半導体膜に対して 1 5 族のみ或いは 1 3 族及び 1 5 族から選ばれた不純物を添加する工程と、
加熱処理により前記不純物を含む導電層に対して前記触媒元素をゲッタリングさせる工程と、
前記導電層上にソース電極及びドレイン電極を形成する工程と、
前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして前記結晶構造を有する半導体膜をエッチングすることでチャネル形成領域を形成する工程と、
前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして前記チャネル形成領域のみに対してしきい値電圧制御用の不純物を添加する工程と、
を構成に含むことを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

【 発明の実施の形態 】

以上の構成からなる本願発明の実施の形態について、以下に記載する実施例でもって詳細な説明を行うこととする。

【 0 0 2 5 】

【 実施例 】

〔 実施例 1 〕

本願発明の代表的な実施例について、図 1 ～ 3 を用いて説明する。まず、図 1 を用いて本願発明の半導体装置の作製方法を説明する。

【 0 0 2 6 】

ガラス基板（または石英、シリコン基板）1 0 1 上に珪素を主成分とする絶縁膜でなる下地膜 1 0 2 を形成する。その上に導電性膜でなるゲイト電極（第 1 配線）1 0 3 を形成する。

【 0 0 2 7 】

ゲイト電極 1 0 3 の線幅は 1 ～ 1 0 μm （代表的には 3 ～ 5 μm ）とする。また、膜厚は 200 ～ 500 nm（代表的には 250 ～ 300 nm）とする。本実施例では 250nm 厚の T a（タンタ

10

20

30

40

50

ル)及びTa₂N(窒化タンタル)の積層膜(例えばTa/Ta₂N)を用いて線幅3μmのゲイト電極を形成する。

【0028】

また、ゲイト電極103としては、少なくとも600(好ましくは800)の温度に耐えうる耐熱性を有する材料(タンタル、タングステン、チタン、クロム、モリブデン、導電性シリコン等)を用いる。その理由は後述する。ここで1回目のパターニング工程(ゲイト電極形成)が行われる。

【0029】

次に、窒化珪素膜104(膜厚は0~200nm、代表的には25~100nm、好ましくは50nm)、SiO_xN_yで示される酸化窒化珪素膜又は酸化珪素膜(膜厚は150~800nm、代表的には200~500nm、好ましくは300~400nm)105からなるゲイト絶縁層を形成し、その上に珪素を主成分とする非晶質半導体膜106を形成する。本実施例では非晶質珪素膜を例とするが他の化合物半導体膜(ゲルマニウムを含有する非晶質珪素膜等)を用いても良い。

【0030】

また、本願発明はチャネルエッチング型のボトムゲイト構造であるので、非晶質珪素膜106の膜厚は厚く形成しておく。膜厚範囲は100~600nm(典型的には200~300nm、好ましくは250nm)とする。本実施例では200nmとする。また、後述するが、最適な膜厚は本願発明のTF₂Tにどのようなオフセット領域、LDD領域を設けるかによって適宜決定する必要がある。

【0031】

なお、本実施例では減圧熱CVD法により非晶質珪素膜106を成膜するが、成膜の際に炭素、酸素、窒素といった不純物の濃度を徹底的に管理することが望ましい。これらの不純物が多いと後の結晶化を阻害する恐れがある。

【0032】

本実施例では成膜した非晶質珪素膜中における各不純物の濃度が、炭素及び窒素が 5×10^{18} atoms/cm³未満(代表的には 5×10^{17} atoms/cm³以下)、酸素が 1.5×10^{19} atoms/cm³未満(代表的には 1×10^{18} atoms/cm³以下)となる様に制御する。この様な管理を行っておけば最終的にTF₂Tのチャネル形成領域中に含まれる不純物濃度は上記範囲内に収まる。

【0033】

こうして図1(A)の状態が得られる。その次に、珪素の結晶化を助長する触媒元素(代表的にはニッケル)を含んだ溶液をスピンコート法により塗布し、Ni(ニッケル)含有層107を形成する。詳細な条件は本発明者らによる特開平7-130652号公報記載の技術(ここでは同公報の実施例1)を参照すると良い。なお、同公報の実施例2に記載された技術を用いても良い。(図1(B))

【0034】

なお、同公報ではNiを含んだ水溶液を塗布する手段を示しているが、以下の添加手段を用いることも可能である。

(1)イオン注入法又はイオンドーピング法による直接的添加。

(2)Ni電極を用いたプラズマ処理による添加。

(3)CVD法、スパッタ法または蒸着法によるNi膜またはNi_xSi_y(ニッケルシリサイド)膜の形成。

【0035】

また、珪素の結晶化を助長する触媒元素としては、Ni以外にもGe(ゲルマニウム)、Co(コバルト)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、鉄(Fe)、銅(Cu)、金(Au)、鉛(Pb)等を用いることができる。

【0036】

Ni含有層107を形成したら、450~500(2時間程の加熱処理(水素出し工程)の後、500~700(代表的には550~600)の温度で2~12時間(代表的には4~8時間

10

20

30

40

50

）の加熱処理を行い、結晶構造を有する半導体膜（本実施例の場合には結晶性珪素膜（ポリシリコン膜））108を得る。本実施例の場合、結晶化は非晶質珪素膜106の表面近傍から始まり、概略矢印の方向に向かって進行する。（図1（C））

【0037】

次に、レーザー光またはそれと同等の強度を持つ強光を照射することにより結晶性珪素膜108の結晶性の改善工程を行う。ここでは粒内欠陥の低減、不整合粒界の低減及び非晶質成分の結晶化などが行われ、非常に結晶性に優れた結晶性珪素膜109が得られる。（図1（D））

【0038】

次に、15族から選ばれた元素（代表的にはリン、砒素またはアンチモン）をイオン注入法（質量分離あり）またはイオンドーピング法（質量分離なし）により添加する。本実施例では結晶性珪素膜109の表面から深さ30～100nm（代表的には30～50nm）の範囲において、リン濃度が $1 \times 10^{19} \sim 3 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ （代表的には $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ ）となる様に調節する。

【0039】

本実施例ではこの様にして形成された高濃度のリンを含む領域110を n^+ 層（または第1の導電層）と呼ぶ。この層の厚さは30～100nm（代表的には30～50nm）の範囲で決定する。この場合、 n^+ 層110は後にソース/ドレイン電極の一部として機能する。本実施例では30nm厚の n^+ 層を形成する。

【0040】

また、 n^+ 層110の下に形成される低濃度にリンを含む領域111を n^- 層（または第2の導電層）と呼ぶ。この場合、 n^- 層111は n^+ 層110よりも高抵抗となり、後に電界緩和のためのLDD領域として機能する。本実施例では30nm厚の n^- 層を形成する。（図1（E））

【0041】

また、この時、リンを添加する際の深さ方向の濃度プロファイルが非常に重要である。この事について図4を用いて説明する。なお、図4に示す濃度プロファイルは加速電圧を80 keV、RF電力を20 Wとしてイオンドーピング法によりフォスフィン（ PH_3 ）を添加した場合の例である。

【0042】

図4において、401は結晶性珪素膜、402は添加されたリンの濃度プロファイルを示している。この濃度プロファイルはRF電力、添加イオン種、加速電圧等の設定条件によって決定される。

【0043】

この時、濃度プロファイル402のピーク値は n^+ 層403内部又は界面近傍にあり、結晶性珪素膜401の深くにいく程（ゲイト絶縁膜に向かうほど）、リン濃度は低下する。この時、リン濃度は膜内部全域に渡って連続的に変化するため n^+ 層403の下には必ず n^- 層404が形成される。

【0044】

そして、この n^- 層404の内部においてもリン濃度は連続的に低下していく。本実施例では、リン濃度が $1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ を超える領域を n^+ 層403として考え、 $5 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度範囲にある領域を n^- 層404として考えている。ただし、明確な境界は存在しないため、目安として考えている程度である。

【0045】

また、リン濃度が極端に低下した領域及びそのさらに下層は真性または実質的に真性な領域（ i 層）405となる。なお、真性な領域とは意図的に不純物が添加されない領域を言う。また、実質的に真性な領域とは、不純物濃度（ここではリン濃度）が珪素膜のスピン密度以下である領域又は不純物濃度が $1 \times 10^{14} \sim 1 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ の範囲で一導電性を示す領域を指す。

【0046】

10

20

30

40

50

この様な真性または実質的に真性な領域は n^- 層404の下に形成される。ただし、 i 層405は基本的にチャネル形成領域と同一導電型の半導体層から構成される。即ち、チャネル形成領域が弱い n 型又は p 型を示す様な場合には、同様の導電型を示す。

【0047】

この様に、 n^+ 層の形成にイオン注入法またはイオンドーピング法を用いることにより n^+ 層の下に n^- 層を形成することができる。従来のように n^+ 層を成膜で設けた場合にはこの様な構成は実現できない。また、イオン添加時の条件を適切に設定することで n^+ 層と n^- 層の厚さ制御を容易に行うことができる。

【0048】

特に、 n^- 層111の厚さは後にLDD領域の厚さとなるため、非常に精密な制御が必要である。イオンドーピング法等では添加条件の設定によって深さ方向の濃度プロファイルが精密に制御できるので、LDD領域の厚さ制御が容易に行える。本願発明では n^- 層111の厚さを30~200 nm(代表的には50~150 nm)の範囲で調節すれば良い。

【0049】

次に、図1(E)の状態が得られたら、500~700 (代表的には600~650)の温度で0.5~8時間(代表的には1~4時間)の加熱処理(ファースアニール)を行い、 i 層中のNiを n^+ / n^- 層へと移動させる。この時、Niは概略矢印の方向に向かってゲッタリングされる。(図2(A))

【0050】

この様に、本実施例は n^+ 層110、 n^- 層111に含まれたリンをNiをゲッタリングするために利用し、 n^+ / n^- 層をゲッタリング領域として活用する点に大きな特徴がある。また、Niをゲッタリングした n^+ / n^- 層の一部はそのままソース/ドレイン領域を構成する第1及び第2の導電層として残るが、ゲッタリング後は不活性なリン化ニッケルとなるので問題はない。

【0051】

また、この場合、Niが移動すべき距離は結晶性珪素膜の膜厚分に相当する距離でしかないので非常に速やか(短時間のうち)にゲッタリングが終了する。そのため、(1)添加するリン濃度の低減、(2)加熱処理温度の低下、(3)加熱処理時間の短縮化を実現しうる。

【0052】

なお、本実施例ではガラス基板上にTFTを作製するのでガラスの耐熱性でプロセス最高温度が決定されてしまう。しかしながら、基板として石英基板など耐熱性の高い基板を用いれば、ゲッタリングのための加熱処理の最高温度を1000 (好ましくは800)にまで上げることができる。温度が800を超えるとゲッタリング領域から被ゲッタリング領域へのリンの逆拡散が起こり始めるので好ましくない。

【0053】

また、ゲイト電極103の耐熱性を少なくとも600 (好ましくは800)の温度に耐えうるようにしたのは、このゲッタリング工程を考慮しての事である。勿論、ゲッタリング工程をファースアニールによらず、ランプアニール等で行う場合にはゲイト電極の許容範囲も広がる。

【0054】

こうして触媒元素を n^+ / n^- 層へとゲッタリングすると、 i 層に含まれるNi濃度は $5 \times 10^{17} \text{atoms/cm}^3$ 以下にまで低減される。なお、現状ではSIMS(質量二次イオン分析)の検出限界の都合で $2 \times 10^{17} \text{atoms/cm}^3$ 以下となることしか判らないが、おそらく i 層中のスピン密度以下($1 \times 10^{14} \text{atoms/cm}^3$ 位)まで低減されているものと予想される。

【0055】

触媒元素のゲッタリング工程が終了したら、結晶性珪素膜のパターニングを行い、島状半導体層112を形成する。この時、最終的にTFTが完成した時にキャリアの移動方向に対して垂直な方向の長さ(チャネル幅(W))が1~30 μm (代表的には10~20 μm)となる様に調節する。ここで2回目のパターニング工程が行われる。(図2(B))

10

20

30

40

50

【 0 0 5 6 】

ここで図面上には図示されないが、露出したゲイト絶縁層の一部をエッチングし、ゲイト電極（第1配線）と次に形成する電極（第2配線）との電氣的接続をとるためのコンタクトホール（図2（D）の119で示される領域）を開口する。ここで3回目のパターニング工程が行われる。

【 0 0 5 7 】

次に、導電性を有する金属膜（図示せず）を成膜し、パターニングによりソース電極113、ドレイン電極114を形成する。本実施例ではTi（50nm）/Al（200～300 nm）/Ti（50nm）の3層構造からなる積層膜を用いる。また、上述の様にゲイト電極と電氣的に接続するための配線も同時に形成されている。ここで4回目のパターニング工程が行

10

【 0 0 5 8 】

また、後述するが、ゲイト電極103の真上の領域、即ちソース電極113とドレイン電極114とで挟まれた領域（以下、チャンネルエッチング領域と呼ぶ）115の長さ（ C_1 で示される）が後にチャンネル形成領域とオフセット領域の長さを決定する。 C_1 は2～20 μm （代表的には5～10 μm ）の範囲から選べるが、本実施例では $C_1 = 4 \mu\text{m}$ とする。

【 0 0 5 9 】

次に、ソース電極113及びドレイン電極114をマスクとしてドライエッチングを行い、自己整合的に島状半導体層112をエッチングする。そのため、チャンネルエッチング領域115のみでエッチングが進行する。（図2（D））

20

【 0 0 6 0 】

この時、 n^+ 層110は完全にエッチングされ、真性または実質的に真性な領域（i層）のみが残された形でエッチングを止める。本願発明では最終的に10～100 nm（代表的には10～75nm、好ましくは15～45nm）の半導体層のみを残す。本実施例では30nm厚の半導体層を残すことにする。

【 0 0 6 1 】

こうして島状半導体層112のエッチング（チャンネルエッチング工程）が終了したら、保護膜116として酸化珪素膜または窒化珪素膜を形成して、図2（D）に示す様な構造の逆スタガ型TFETを得る。

【 0 0 6 2 】

この状態において、チャンネルエッチングされた島状半導体層112のうち、ゲイト電極113の真上に位置する領域はチャンネル形成領域117となる。本実施例の構成ではゲイト電極幅がチャンネル形成領域の長さに対応し、 L_1 で示される長さをチャンネル長と呼ぶ。また、ゲイト電極113の端部よりも外側に位置する領域118は、ゲイト電極113からの電界が及ばず、オフセット領域となる。この長さは X_1 で示される。

30

【 0 0 6 3 】

本実施例の場合、ゲイト電極113の線幅（ L_1 に相当する）が3 μm であり、チャンネルエッチング領域115の長さ（ C_1 ）が4 μm であるので、オフセット領域の長さ（ X_1 ）は0.5 μm となる。

【 0 0 6 4 】

ここで、ドレイン領域（ドレイン電極114と接する半導体層）を拡大したものを図3に示す。図3において、103はゲイト電極、301はチャンネル形成領域、302は n^+ 層（ソースまたはドレイン電極）、303、304は膜厚の異なるオフセット領域、305は n^- 層（LDD領域）である。

40

【 0 0 6 5 】

なお、ここでは説明しないがソース領域（ソース電極113と接する半導体層）も同様の構造を有している。

【 0 0 6 6 】

また、図3に示す構造は模式的に記されているが、各領域の膜厚関係には注意が必要である。本願発明を構成するにあたって最も好ましい構成は、膜厚の厚さが n^+ 層302 < n^-

50

n^- 層 305 < オフセット領域 (i 層) 304 の関係にある場合である。

【0067】

なぜならば n^+ 層 302 は電極として機能するだけなので薄くて十分である。一方、 n^- 層 305 及びオフセット領域 304 は電界緩和を効果的に行うために適切な厚さが必要である。

【0068】

本実施例の構成では、チャンネル形成領域 301 から n^+ 領域 302 に至るまでに膜厚の異なる二つのオフセット領域 303、304 及び LDD 領域 305 が存在する。なお、303 はマスク合わせにより形成される膜面方向のオフセット領域であり、マスクオフセット領域と呼ぶ。

【0069】

また、304 は i 層の膜厚分に相当する膜厚方向のオフセット領域であり、厚さオフセット領域と呼ぶ。厚さオフセット領域 304 の厚さは 100 ~ 300 nm (代表的には 150 ~ 200 nm) の範囲で決定すれば良い。ただし、チャンネル形成領域の膜厚よりも膜厚をが厚くする必要がある。チャンネル形成領域よりも膜厚が薄いと良好なオフセット効果を望めない。

【0070】

この様なオフセット + LDD からなる構造を本発明者らは HRD (High Resistance Drain) 構造と呼び、通常の LDD 構造とは区別して考えている。本実施例の場合、HRD 構造はマスクオフセット + 厚さオフセット + LDD の 3 段構造で構成されることになる。

【0071】

この時、LDD 領域 303 は LDD 領域の膜厚及び不純物濃度によって制御されるため、非常に再現性が高く、特性バラツキが小さいという利点を有する。パターニングによって形成された LDD 領域ではパターニング誤差による特性バラツキが問題となることは従来例で述べた通りである。

【0072】

なお、マスクオフセット領域 303 の長さ (X_1) はパターニングによって制御されるため、パターニングやガラスの縮み等による誤差の影響を受ける。しかしながら、その後厚さオフセット領域 304 と LDD 領域 305 とが存在するので誤差による影響は緩和され、特性バラツキを小さくすることができる。

【0073】

なお、マスクオフセットの長さ (X_1) はチャンネル長 (L_1) とチャンネルエッチング領域の長さ (C_1) を用いて ($C_1 - L_1$) / 2 で表される。従って、ソース/ドレイン電極形成時のパターニング工程によって所望のオフセット長 (X_1) を設定することが可能である。本実施例の構成ではオフセット長 (X_1) は 0.3 ~ 3 μ m (代表的には 1 ~ 2 μ m) とすることができる。

【0074】

なお、図 2 (D) に示す様な構造の逆スタガ型 TFT は、従来の非晶質珪素膜を活性層 (島状半導体層) として利用した TFT では実現できない。なぜならば、非晶質珪素膜を用いる場合、ソース/ドレイン電極とゲイト電極とがオーバーラップする様な構造にしないとキャリア (電子または正孔) の移動度が極めて遅くなってしまふからである。

【0075】

ソース/ドレイン電極とゲイト電極とがオーバーラップする様な構造にしたとしても非晶質珪素膜を用いた TFT のモビリティ (電界効果移動度) はせいぜい 1 ~ 10 cm^2/Vs 程度である。それに対して本実施例の様な構造を採用してしまつてはモビリティが低すぎてスイッチング素子として機能しない。

【0076】

ところが、本願発明では活性層として結晶性珪素膜を利用しているのでキャリア移動度が十分に速い。従って、本実施例の様な構造としても十分なモビリティを得ることが可能である。即ち、本実施例の構造は半導体層として結晶構造を有する半導体膜を用いたからこそ実現できるのである。

10

20

30

40

50

【0077】

また、本実施例の逆スタガ型TF Tは、HR D構造を有しているので衝突電離によるホットキャリア注入などの劣化現象に対して非常に強く、高い信頼性を有している。しかも、LDD領域の効果が支配的な上、そのLDD領域が非常に制御性よく形成されているので特性バラツキが非常に小さい。

【0078】

そのため、本実施例の様な構造は高耐圧を必要とし、高い動作速度はそれほど必要としない様な回路を構成するTF Tに好適である。

【0079】

また、本実施例の作製工程に示した様に、図2(D)に示した構造の逆スタガ型TF Tを得るのに4枚のマスキが必要としていない。これは従来のチャンネルストップ型TF Tが6枚マスクを必要としていた事を考えると、スループット及び歩留りが飛躍的に向上することを意味している。

10

【0080】

以上の様に、本実施例の構成によれば量産性の高い作製工程によって、高い信頼性と再現性を有するボトムゲイト型TF Tを作製することが可能である。

【0081】

なお、本実施例の作製工程に従って作製したボトムゲイト型TF T(Nチャンネル型TF T)のモビリティは $30 \sim 250 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ (代表的には $10 \sim 150 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)、しきい値電圧は $0 \sim 3 \text{ V}$ を実現しうる。

20

【0082】

〔実施例2〕

本実施例では本願発明の構成において、実施例1とは異なる構成例を示す。TF Tの作製工程は基本的には実施例1に従えば良いので、本実施例では必要な部分のみを説明することにする。

【0083】

まず、実施例1の作製工程に従って図5(A)の状態を得る。ここで実施例1と異なる点は、ソース電極501、ドレイン電極502を形成する際にチャンネルエッチング領域500の長さを C_2 とする点にある。この時、 C_2 はゲイト電極幅よりも狭く、 $2 \sim 9 \mu\text{m}$ (代表的には $2 \sim 4 \mu\text{m}$)の範囲で選ばれる。即ち、ゲイト電極とソース/ドレイン電極とがオーバーラップする様に設けることが本実施例の特徴となる。

30

【0084】

この状態で実施例1に示した様にチャンネルエッチング工程を行い、保護膜を設けると図5(B)の状態を得る。この時、503で示される領域がチャンネル形成領域となり、そのチャンネル長は $L_2 (= C_2)$ で表される。また、マスク設計によりオーバーラップさせた領域(マスクオーバーラップ領域と呼ぶ)504の長さ(Y_2)はゲイト電極幅をEとすると、 $(E - L_2) / 2$ で表される。

【0085】

図5(C)はドレイン領域の拡大図であるが、TF T動作時のキャリアは、チャンネル形成領域503(厚さ50nm)、マスクオーバーラップ領域504(厚さ160 nm)、LDD領域505(厚さ50nm)を通して n^+ 層506(厚さ40nm)、ドレイン電極502へと到達する。

40

【0086】

なお、この場合、マスクオーバーラップ領域504にもゲイト電極からの電界が形成されるが、LDD領域505に近づくにつれて電界は弱まるので、その様な領域は実質的にLDD領域と同様の機能を持つ。勿論、さらにLDD領域505に近づけば完全に電界が形成されなくなり、オフセット(厚さオフセット)領域としても機能しうる。

【0087】

この様に本実施例の構造ではHR D構造が、オーバーラップによる実質的なLDD+厚さオフセット+低濃度不純物によるLDDで構成される。また、オーバーラップ領域504

50

の膜厚が薄い場合には、オーバーラップによる実質的なＬＤＤ＋低濃度不純物によるＬＤＤのみからなるＬＤＤ構造もとりうる。

【００８８】

本実施例の構成においても、オーバーラップ領域５０４、ＬＤＤ領域５０５がそれぞれの膜厚で制御されるので非常に特性バラツキが小さい。また、オーバーラップ領域の長さ（ Y_2 ）はパターンニング等による誤差を含むが、オーバーラップによるＬＤＤ、厚さ方向のオフセット及び低濃度不純物によるＬＤＤはその様な誤差の影響を受けないので Y_2 の誤差による特性バラツキは緩和される。

【００８９】

なお、本実施例の様な構造はオフセット成分が少なく、高い動作速度を必要とする様な回路を構成するＴＦＴに好適である。

10

【００９０】

また、本実施例の構造では衝突電離によってチャネル形成領域内に蓄積した少数キャリアが速やかにソース電極へと引き抜かれるので基板浮遊効果を起こしにくいという利点を有する。そのため、動作速度が速い上に非常に耐圧特性の高いＴＦＴを実現することが可能である。

【００９１】

〔実施例３〕

本実施例では本願発明の構成において、実施例１、２とは異なる構成例を示す。ＴＦＴの作製工程は基本的には実施例１に従えば良いので、本実施例では必要な部分のみを説明することにする。

20

【００９２】

まず、実施例１の作製工程に従って図６（Ａ）の状態を得る。ここで実施例１と異なる点は、ソース電極６０１、ドレイン電極６０２を形成する際にチャネルエッチング領域６００の長さを C_3 とする点にある。この時、 C_3 はゲイト電極幅と一致させるため、 $1 \sim 10 \mu m$ （代表的には $3 \sim 5 \mu m$ ）となる。

【００９３】

この状態で実施例１に示した様にチャネルエッチング工程を行い、保護膜を設けると図６（Ｂ）の状態を得る。この時、６０３で示される領域がチャネル形成領域となり、そのチャネル長は L_3 （ $= C_3$ ）で表される。

30

【００９４】

図６（Ｃ）はドレイン領域の拡大図であるが、ＴＦＴ動作時のキャリアは、チャネル形成領域６０３（厚さ $100 nm$ ）、厚さオフセット領域６０４（厚さ $150 nm$ ）、ＬＤＤ領域６０５（厚さ $100 nm$ ）を通して n^+ 層６０６（厚さ $50 nm$ ）、ドレイン電極６０２へと到達する。即ち、本実施例の構造ではＨＲＤ構造が厚さオフセット＋ＬＤＤの２段構造で構成される。

【００９５】

本実施例の構成においても、厚さオフセット領域６０４、ＬＤＤ領域６０５がそれぞれの膜厚で制御されるので非常に特性バラツキが小さい。また、十分な耐圧特性を得ることが可能である。

40

【００９６】

〔実施例４〕

本実施例では本願発明の構成において、実施例１～３とは異なる構成例を示す。ＴＦＴの作製工程は基本的には実施例１に従えば良いので、本実施例では必要な部分のみを説明することにする。

【００９７】

まず、実施例１の作製工程に従って図７（Ａ）の状態を得る。ここで実施例１と異なる点は、ソース電極７０１、ドレイン電極７０２を形成する際にソース電極またはドレイン電極のいずれか一方をゲイト電極にオーバーラップさせ、他方はオーバーラップさせない構成とする点にある。

50

【 0 0 9 8 】

なお、本実施例ではチャンネルエッチング領域 7 0 0 の長さを C_4 とする。この時、 C_4 は $1 \sim 10 \mu m$ (代表的には $3 \sim 6 \mu m$) の範囲で選ばれる。

【 0 0 9 9 】

この状態で実施例 1 に示した様にチャンネルエッチング工程を行い、保護膜を設けると図 7 (B) の状態を得る。この時、7 0 3 で示される領域がチャンネル形成領域となり、そのチャンネル長は $L_4 (= C_4 - X_4)$ で表される。

【 0 1 0 0 】

ここで、 X_4 はマスクオフセット領域 7 0 4 の長さである。 X_4 の数値範囲については実施例 1 を参考にすれば良い。また、マスクオーバーラップ領域 7 0 5 の長さの数値範囲は実施例 2 を参考にすれば良い。

10

【 0 1 0 1 】

本実施例は、実施例 1 で説明した H R D 構造と実施例 2 で説明した H R D 構造 (または L D D 構造) とを組み合わせた構成である。構造的な説明は実施例 1 及び実施例 2 で既に説明したのでここでの説明は省略する。

【 0 1 0 2 】

本実施例の様な構造を採用する場合、特にソース領域に実施例 2 に示した H R D 構造 (または L D D 構造) を用い、ドレイン領域に実施例 1 で説明した H R D 構造を用いることが好ましい。

【 0 1 0 3 】

例えば、ドレイン領域側のチャンネル端部 (接合部) では特に電界集中が激しく、実施例 1 に示した様な抵抗成分の多い H R D 構造が望ましい。逆に、ソース側ではそこまでの高耐圧対策は必要ないので、実施例 2 に示した様な抵抗成分の少ない H R D (または L D D) 構造が適している。

20

【 0 1 0 4 】

なお、本実施例において、ソース / ドレイン領域側のいずれか一方に実施例 2 の構成を組み合わせることも可能である。この様に、実施例 1 ~ 3 に示した H R D 構造または L D D 構造を実施者が適宜選択してソース / ドレイン領域に採用し、回路設計を鑑みて最適な構造を設計すれば良い。この場合、 $3^2 = 9$ 通りの組み合わせパターンが可能である。

【 0 1 0 5 】

〔 実施例 5 〕

本実施例では実施例 1 ~ 4 に示した構成のボトムゲイト型 T F T を用いて C M O S 回路 (インバータ回路) を構成する場合の例について図 8 を用いて説明する。なお、C M O S 回路は同一基板上に形成された N チャンネル型 T F T (N T F T と略記する) と P チャンネル型 T F T (P T F T と略記する) とを相補的に組み合わせて構成する。

30

【 0 1 0 6 】

図 8 は実施例 4 に示した構成を利用した C M O S 回路であり、8 0 1 は P T F T のソース電極、8 0 2 は N T F T のソース電極、8 0 3 は N / P 共通のドレイン電極である。

【 0 1 0 7 】

また、N T F T は実施例 1 で説明した作製工程によって n^+ 層 8 0 4、8 0 5、 n^- 層 8 0 6、8 0 7 が形成されている。一方、P T F T の方には p^{++} 層 8 0 8、8 0 9、 p^- 層 8 1 0、8 1 1 が形成されている。

40

【 0 1 0 8 】

なお、同一基板上に C M O S 回路を作製することは非常に容易である。本願発明の場合、まず、実施例 1 の工程に従って図 2 (B) の状態を得る。

【 0 1 0 9 】

この状態では N 型 / P 型関係なく 1 5 族から選ばれた元素が全面に添加されているが、P T F T を作製する場合には N T F T とする領域をレジストマスク等で隠して 1 3 族から選ばれた元素 (代表的にはボロン、インジウムまたはガリウム) を添加すれば良い。

【 0 1 1 0 】

50

本実施例ではボロンを例にとるが、この時、ボロンはリンの濃度の少なくとも3倍以上（代表的には $3 \times 10^{19} \sim 1 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$ 、好ましくは $3 \times 10^{20} \sim 3 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ ）に添加して導電性を反転させなければならない。また、 n^+ 層及び n^- 層全てを完全に p^{++} 層及び p^- 層に反転させるためには、ボロン添加時の濃度プロファイルを調節してリンの添加深さよりも深く添加することが重要である。

【0111】

従って、ボロンの膜中における濃度プロファイルは図9のようになる。図9において、900は半導体層、901はボロン添加前のリンの濃度プロファイル、902はボロン添加後のボロンの濃度プロファイル、903は p^{++} 層、904は p^- 層、905はi層である。

【0112】

この時、 p^{++} 層903の厚さは10～150 nm（代表的には50～100 nm）とし、 P^- 層904の厚さは30～300 nm（代表的には100～200 nm）とする。ただし、PTFTは元来劣化に強いので p^- 層をLDD領域として利用する必要性は必ずしもない。わざわざ p^- 層904の膜厚について言及したのは、イオン注入法等の添加手段を用いる限り、連続的に変化する濃度勾配によって必ず p^- 層が形成されるからである。

【0113】

ところで、本実施例ではNTFTとPTFTのどちらもソース領域側には実施例2に示した構成のHRD構造（オーバーラップ領域を利用したタイプ）を用い、ドレイン領域側には実施例1に示した構成のHRD構造（マスクオフセットを利用したタイプ）を設けている。

【0114】

そのため、上面図で明らかな様にPTFTのソース領域側には Y_i の長さを持つオーバーラップ領域を有し、ドレイン領域側には X_i の長さを持つマスクオフセット領域を有している。また、NTFTのソース領域側には Y_j の長さを持つオーバーラップ領域を有し、ドレイン領域側には X_j の長さを持つマスクオフセット領域を有している。

【0115】

この時、 X_i と X_j 、 Y_i と Y_j の長さはそれぞれマスク設計によって自由に調節できる。従って、それぞれの長さは回路構成の必要に応じて適宜決定すれば良く、Nチャンネル型とPチャンネル型とで揃える必要はない。

【0116】

また、このような構造ではCMOS回路の共通ドレインとなる領域の耐压特性を高くすることができるので、動作電圧の高い回路を構成する場合において、非常に有効な構成である。

【0117】

なお、実施例1～4に示した構成のTFTを用いたCMOS回路の構成を図8に示したが、これ以外の全ての組み合わせも可能であることは言うまでもない。可能な構成パターンとしては、一つのTFTについて9通りあるので、CMOS回路では $9^2 = 81$ 通りがある。これらの複数の組み合わせの中から、回路が必要とする性能に応じて最適な組み合わせを採用していけば良い。

【0118】

また、本実施例に示した様に本願発明はPTFTにも容易に適用することができる。その場合、本願発明のボトムゲイト型TFT（PTFT）のモビリティは $30 \sim 150 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ （代表的には $10 \sim 100 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ）、しきい値電圧は $-1 \sim -3 \text{ V}$ を実現しうる。

【0119】

〔実施例6〕

本実施例では、珪素の結晶化を助長する触媒元素としてGe（ゲルマニウム）を利用した場合の例について説明する。Geを利用する場合、汎用性の高さからイオン注入法、イオンドーピング法またはプラズマ処理による添加を行うことが好ましい。また、Geを含む雰囲気中で熱処理を行うことで気相から添加することも可能である。

【0120】

GeはSi（シリコン）と同じ14族に属する元素であるため、Siとの相性が非常に良い。GeとSiとの化合物（ $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ で示される。ただし $0 < x < 1$ ）は本願発明の半導体層として活用することもできることは既に述べた。

【0121】

そのため、本実施例の様にGeを用いた非晶質珪素膜の結晶化を行った場合、結晶化後に触媒元素をゲッタリングする必要性がない。勿論、ゲッタリング工程を行っても構わないが、TFET特性に影響はない。

【0122】

従って、ゲッタリング工程の加熱処理を省略することができるので製造工程のスループットが大幅に向上する。また、 $\text{Si}_x\text{Ge}_{1-x}$ 膜を用いたTFETは高いモビリティを示すことが知られているので、珪素膜中におけるGeの含有量が適切であれば動作速度の向上も期待しうる。

【0123】

なお、本実施例の構成は実施例1～5のいずれの構成に対しても適用することが可能である。

【0124】

〔実施例7〕

本実施例では、本願発明のTFETに対してしきい値電圧を制御するための工夫を施した場合の例について説明する。

【0125】

しきい値電圧を制御するために13族（代表的にはボロン、インジウム、ガリウム）または15族（代表的にはリン、砒素、アンチモン）から選ばれた元素をチャネル形成領域に対して添加する技術はチャネルドーピングと呼ばれている。

【0126】

本願発明に対してチャネルドーピングを行うことは有効であり、以下に示す2通りの方法が簡易で良い。

【0127】

まず、非晶質珪素膜を成膜する時点において成膜ガスにしきい値電圧を制御するための不純物を含むガス（例えばジボラン、フォスフィン等）を混在させ、成膜と同時に所定量を含有させる方式がある。この場合、工程数を全く増やす必要がないが、N型及びP型の両TFETに対して同濃度が添加されるため、両者で濃度を異ならせるといった要求には対応できない。

【0128】

次に、図2（D）で説明した様なチャネルエッチング工程（チャネル形成領域の形成工程）が終了した後で、ソース/ドレイン電極をマスクとしてチャネル形成領域（またはチャネル形成領域とマスクオフセット領域）に対して選択的に不純物添加を行う方式がある。

【0129】

添加方法はイオン注入法、イオンドーピング法、プラズマ処理法、気相法（雰囲気からの拡散）、固相法（膜中からの拡散）など様々な方法を用いることができるが、チャネル形成領域が薄いので、気相法や固相等の様にダメージをあたえない方法が好ましい。

【0130】

なお、イオン注入法等を用いる場合には、TFET全体を覆う保護膜を設けてから行えばチャネル形成領域のダメージを減らすことができる。

【0131】

また、不純物を添加した後はレーザーアニール、ランプアニール、ファーンেসアニールまたはそれらを組み合わせて不純物の活性化工程を行う。この時、チャネル形成領域が受けたダメージも殆ど回復する。

【0132】

本実施例を実施する場合、チャネル形成領域には $1 \times 10^{15} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ （代表的には $1 \times 10^{15} \sim 5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ ）の濃度でしきい値電圧を制御するための不純物を添

10

20

30

40

50

加すれば良い。

【0133】

そして、本実施例を本願発明のTFTに実施した場合、Nチャネル型TFTのしきい値電圧を0.5~2.5Vの範囲に収めることができる。また、Pチャネル型TFTに適用した場合にはしきい値電圧を-0.1~-2.0Vの範囲に収めることが可能である。

【0134】

なお、本実施例の構成は実施例1~6のいずれの構成との組み合わせも可能である。また、実施例5のCMOS回路に適用する場合、N型TFTとP型TFTとで添加濃度や添加する不純物の種類を異なるものとすることもできる。

【0135】

〔実施例8〕

図2(D)に示した構造では、島状半導体層を完全に囲む様にしてソース電極113とドレイン電極114とが形成されている。本実施例ではこれとは別の構成について説明する。

【0136】

図10(A)に示す構造は、基本的には図2(D)と似ているが、ソース電極11及びドレイン電極12の形状が異なる点に特徴がある。即ち、一部において島状半導体層(厳密にはソース/ドレイン領域)よりもaで示される距離だけ内側にソース電極11及びドレイン電極12が形成されている。

【0137】

また、13で示される領域は、チャネル形成領域14と同じ膜厚を有する領域であり、距離aの幅を持つ。図面上では模式的に表しているが、距離aは1~300μm(代表的には10~200μm)である。

【0138】

ここで作製工程と照らし合わせて本実施例の特徴を説明する。本実施例では図10(B)に示す様にソース電極11及びドレイン電極12を形成する。ここで15は島状半導体層であり、端部16が露出する。

【0139】

この状態でチャネルエッチング工程を行うと、ソース電極11及びドレイン電極12がマスクとなって自己整合的に島状半導体層15がエッチングされる。この場合、端部16も同時にエッチングされる。

【0140】

この様にして図10(A)の様な構造が得られる。従って、端部16がチャネル形成領域14と同じ膜厚を有することは明らかである。

【0141】

この島状半導体層の突出部13を形成する理由は以下の2つがある。

(1)チャネルエッチング工程におけるエッチングモニタとして利用する。

(2)後工程で保護膜や層間絶縁膜を形成する際に、島状半導体層の段差によるカバレッジ不良を低減する。

【0142】

エッチングモニタとしては、製造過程における抜き取り検査によってチャネル形成領域が適切な膜厚となっているかどうかを検査する場合に用いる。

【0143】

なお、本実施例の構成は実施例1~7のいずれの構成とも組み合わせることが可能である。

【0144】

〔実施例9〕

本実施例では実施例5に示したCMOS回路(インバータ回路)の回路構成の例について図11を用いて説明する。

【0145】

図 1 1 (A) に示すのは、図 8 に示したものと同一構造の C M O S 回路である。この場合、回路構成はゲイト電極 2 0、N 型 T F T の半導体層 2 1、P 型 T F T の半導体層 2 2、N 型 T F T のソース電極 2 3、P 型 T F T のソース電極 2 4、共通ドレイン電極 2 5 から構成される。

【 0 1 4 6 】

なお、各端子部 a、b、c、d はそれぞれ図 1 1 (C) に示したインバータ回路の端子部 a、b、c、d に対応している。

【 0 1 4 7 】

次に、図 1 1 (B) に示すのは、N 型 T F T と P 型 T F T とでドレイン領域となる半導体層を共通化した場合の例である。各符号は図 1 1 (A) で説明した符号に対応している。

10

【 0 1 4 8 】

図 1 1 (B) の構造では T F T 同士を非常に高い密度で形成することができるため、回路を高集積化する場合などに非常に有効である。共通化した半導体層は P N 接合を形成するが問題とはならない。

【 0 1 4 9 】

〔実施例 1 0〕

本実施例では、実施例 1 ～ 5 の構成の T F T 及び C M O S 回路を作製する過程において、加熱処理の手段としてランプアニールを用いる場合の例を示す。

【 0 1 5 0 】

ランプアニールとしては R T A (Rapid Thermal Anneal) による熱処理が知られている。これは赤外ランプからの強光を照射することにより短時間 (数秒から数十秒) で高温の加熱処理を行う技術であり、スループットが非常に良い。また、赤外光以外に補助的に紫外光を用いる場合もある。

20

【 0 1 5 1 】

本願発明においては、非晶質半導体膜の結晶化工程、結晶性半導体膜の結晶性改善工程、触媒元素のゲッタリング工程、しきい値制御のための不純物の活性化工程等に加熱処理を行う。この様な時に本実施例を利用することができる。

【 0 1 5 2 】

なお、本実施例の構成と他の実施例の構成とは自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 5 3 】

30

〔実施例 1 1〕

本実施例では実施例 1 とは異なる手段で触媒元素のゲッタリングを行う場合について説明する。

【 0 1 5 4 】

実施例 1 では 1 5 族から選ばれた元素のみを利用してゲッタリング工程を行っているが、触媒元素のゲッタリング工程は 1 3 族及び 1 5 族から選ばれた元素が添加された状態でも実施することができる。

【 0 1 5 5 】

その場合、まず図 1 (E) に示す状態を得たら、N チャネル型 T F T となる領域のみをレジストマスクで隠して次にボロンを添加する。即ち、N チャネル型 T F T となる領域にはリンのみが存在し、P チャネル型 T F T となる領域にはボロンのみが存在する。

40

【 0 1 5 6 】

そして、その状態で加熱処理を行い、触媒元素のゲッタリング工程を実施すれば良い。本発明者らの実験ではリンのみによるゲッタリング効果よりもリン + ボロンによるゲッタリング効果の方が効果が高いことが確かめられている。ただし、ボロンのみではゲッタリング効果はなく、リン + リンよりも高濃度のボロンという組み合わせの時に高いゲッタリング効果を示した。

【 0 1 5 7 】

なお、本実施例の構成と他の実施例の構成とは自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 5 8 】

50

〔実施例 12〕

基板として耐熱性の高い石英基板やシリコン基板を用いている場合、 n^+ 導電層及び n^- 導電層を形成する前にハロゲン元素を含む酸化性雰囲気中で 700 ~ 1100 程度の加熱処理を行うことも有効である。これはハロゲン元素による金属元素のゲッタリング効果を利用する技術である。

【0159】

また、この技術と実施例 11 に示した様なゲッタリング工程とを併用することでさらに徹底的に非晶質半導体膜の結晶化に利用した触媒元素を除去することができる。こうして、触媒元素を少なくともチャネル形成領域から徹底的に除去しておけば信頼性の高い半導体装置を得ることができる。

【0160】

〔実施例 13〕

本実施例では、実施例 1 で説明した基本的な作製工程に従って、同一基板上にドライバー回路（周辺駆動回路）と画素マトリクス回路とを一体形成したアクティブマトリクス型表示装置を作製する例を示す。

【0161】

本実施例ではドライバー回路としては基本構成である CMOS 回路（図 11（B）に示したタイプ）を示す。なお、ドライバー回路以外に、D/A コンバータ回路、メモリ回路、補正回路などの信号処理回路（これらをドライバー回路と区別するためにロジック回路と呼ぶ）を本願発明の TFT で構成することも可能である。その場合にも CMOS 回路が基本回路として用いられる。

【0162】

また、画素マトリクス回路としてはマルチゲイト型 TFT を用いる例を示す。本実施例ではダブルゲイト構造とする例を示すが、シングルゲイト構造でもトリプルゲイト構造でも構わない。

【0163】

まず、実施例 1 の作製工程を利用して図 2（A）に示す工程（触媒元素のゲッタリング工程）までを終了する。この状態を図 12（A）に示す。

【0164】

図 12（A）において、30 はガラス基板、31 は下地膜、32 は CMOS 回路となる P TFT のゲイト電極、33 は N TFT のゲイト電極である。また、34、35 は画素 TFT のゲイト電極であり、図示されない部分で両電極は接続されている。なお、本実施例ではゲイト電極の材料としてタンタル（Ta）と窒化タンタル（Ta₂N）からなる積層膜を用いる。場合によってはゲイト電極表面に Ta₂O₅ で示される陽極酸化膜を設けてもよい。また、タンタル膜単体でゲイト電極を構成しても良い。

【0165】

また、その上には窒化珪素膜 36、酸化窒化珪素膜 37 が設けられ、さらにその上に半導体層が形成される。本実施例の半導体層は実施例 1 に示した様な手段で結晶化され、その後、リン添加工程が行われて n^+ 層 38、 n^- 層 39、i 層 40 が形成される。これら各層の詳細な条件は実施例 1 に示してある。

【0166】

次に、RTA 処理によるゲッタリング工程を行い、i 層 40 の中に含まれる触媒元素（実施例 1 に従えばニッケル）をリンを含む領域に対してゲッタリングさせる。

【0167】

次に、CMOS 回路の P TFT となる領域以外をレジストマスク（図示せず）で隠して 13 族から選ばれた元素であるボロンを添加する。本実施例では先程添加したリン濃度の 3 倍の濃度のボロンを添加して、 P^{++} 層 41、 P^- 層 42 を形成する。（図 12（B））

【0168】

次に、レーザーアニール工程を行い、イオン注入工程（またはイオンドーピング工程）で非晶質化した結晶性半導体層の結晶性を改善する。また、同時に添加した不純物（リン及

10

20

30

40

50

びボロン)の活性化も行われる。(図12(C))

【0169】

なお、このレーザーアニール工程の前に、RTA処理による脱水素化を行っておくとレーザーアニールの際に水素の突沸現象を防ぐことができる。

【0170】

次に、結晶性半導体層をエッチングして島状半導体層43、44を形成する。なお、この時、次に形成する電極(第2配線)とゲイト配線との一部を接続するためにコンタクトホールを形成する。

【0171】

なお、前述のレーザーアニール工程は結晶性半導体層を島状半導体層に加工してから行うことも可能である。

10

【0172】

そして、導電性を有する薄膜を形成してパターンングを行い、CMOS回路のソース電極45(NTFT)、46(PTFT)、共通ドレイン電極47を形成する。また、画素TFTのソース電極48、ドレイン電極49を形成する。なお、50で示される電極は、マスクとしてのみ機能するため、本明細書中ではマスク電極と呼ぶことにする。(図13(A))

【0173】

図13(A)の状態が得られたら、チャネルエッチング工程を行ってチャネル形成領域51~54を形成する。この時、ドライバー回路の方はどちらのTFTもドレイン側のみにマスクオフセット領域を設けて、両方のソース側にオーバーラップ領域を設けた構成とする。

20

【0174】

また、画素TFTは図13(B)に示す様にソース電極48及びドレイン電極49と接続する方にマスクオフセット領域を設け、マスク電極50の下にはオーバーラップ領域を設けた構成とする。

【0175】

画素TFTはソース/ドレイン領域が映像信号の充放電の際に入れ替わるので、TFT両端の耐圧を高くする必要がある。また、マスク電極50の下方の抵抗成分が高いとスイッチング動作が遅くなるので、オーバーラップ領域を設けてキャリアが移動しやすい状態にすることが望ましい。

30

【0176】

なお、本実施例は最も好ましいと思われる一実施例であり、本実施例がこの構造に限定されることはない。実施者は、実施例1~4で説明したそれぞれの構造の長所を生かして最適な構造を選択すれば良い。

【0177】

次に、酸化窒化珪素膜でなる保護膜55を200nmの厚さに形成して、その上に有機性樹脂膜でなる層間絶縁膜56を形成する。有機性樹脂膜56としてはポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリルを用いることができる。

40

【0178】

次に、層間絶縁膜56に対してコンタクトホールを形成して、透明導電膜(代表的にはITO)から構成される画素電極57を形成する。最後に水素化を行って図13(C)に示す様なアクティブマトリクス基板が完成する。

【0179】

後は、公知のセル組み工程を利用して対向基板とアクティブマトリクス基板との間に液晶層を挟持すればアクティブマトリクス型液晶表示装置を作製することが可能である。

【0180】

なお、本実施例に示したアクティブマトリクス基板を作製するに必要なパターンング回数は7回である。その工程を以下に示す。

(1)ゲイト電極パターンング

50

- (2) ボロン添加領域パターニング
- (3) 島状半導体層パターニング
- (4) ゲイトコンタクトパターニング
- (5) ソース/ドレイン電極パターニング
- (6) ITOコンタクトパターニング
- (7) ITOパターニング

【 0 1 8 1 】

以上の様に、非常に少ないマスク数でアクティブマトリクス基板を作製することができるため、スループットが大幅に向上する。また、同時に実施例 1 ~ 5 に示した構成の T F T を用いて自由に回路設計することができるにので、信頼性と再現性の高い表示装置を容易に実現することができる。

10

【 0 1 8 2 】

なお、本実施例に示した画素マトリクス回路の一部を上面から見た図を図 1 4 (A) に示す。なお、図 1 4 (A) では基本的に本実施例で用いた符号を付してある。従って必要箇所のみを説明することとする。

【 0 1 8 3 】

図 1 4 (A) に示す図を A - A ' で切断した断面図が図 1 4 (B) である。図 1 3 (C) では図示しなかったが、図 1 4 (B) に示す様にゲイト配線と平行に容量配線 5 8 が形成されている。

【 0 1 8 4 】

20

この容量配線 5 8 はドレイン電極 5 0 と重畳する領域 (点線で囲まれた領域) において補助容量 (C s) を形成する。この時、補助容量の誘電体はゲイト絶縁層が担う。なお、補助容量の構造は本実施例に限定されるものではない。

【 0 1 8 5 】

〔 実施例 1 4 〕

本実施例では、実施例 1 3 に示した工程とは異なる構成でアクティブマトリクス型表示装置を作製する場合の例を示す。

【 0 1 8 6 】

本実施例の特徴は、まず、触媒元素を利用した結晶化の後、レーザーアニールによる結晶性の改善工程を行わない点にある。即ち、結晶化後はそのままリンの添加工程、触媒元素のゲッタリング工程等を実施例 1 3 と同様に行う。

30

【 0 1 8 7 】

そして、本実施例の特徴はチャネル形成領域の結晶性改善工程 (不純物の活性化、再結晶化等) を図 1 5 に示す様に保護膜 5 5 を設けた後で行う点にある。即ち、レーザー光は酸化窒化珪素膜でなる保護膜 5 5 を介して照射され、自己整合的にチャネル形成領域 5 1 ~ 5 4 に対して行われる。

【 0 1 8 8 】

この様に図 1 5 の状態でレーザーアニールを行うと、ソース/ドレイン領域からのリンやボロンといった不純物の逆拡散 (Out Diffusion) を抑えることができる。また、レーザー光のパワー (レーザーエネルギー) も半分位で済むという利点を得ることができる。

40

【 0 1 8 9 】

なお、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例 1 ~ 4 で説明したそれぞれの T F T 構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。また、本実施例は他の全ての実施例に示される構成との組み合わせが可能である。

【 0 1 9 0 】

〔 実施例 1 5 〕

本実施例では、実施例 1 3 において、結晶化後のレーザーアニール工程を省略した場合の例を示す。本実施例の場合、結晶化工程後はイオンドーピング法を用いてリンを添加して、R T A により触媒元素のゲッタリング工程を行う。

50

【0191】

そして、次にイオンドーピング法によりボロンを添加してPTFTとなる半導体層上に p^{++} 層41、 p^{-} 層42を形成する。なお、38、39はそれぞれ n^{+} 層と n^{-} 層である。

【0192】

この状態でRTAによるアニール工程を行う。本実施例ではRTAによるアニール処理によって添加された不純物（リン及びボロン）の活性化と半導体層の脱水素化（質量分離をしないイオンドーピングではリンやボロンと一緒に水素も打ち込まれてしまうため）を行っている。（図16（A））

【0193】

次に、レーザーアニール工程を行い、不純物の添加工程で非晶質化した半導体層を再結晶化させ、結晶性を改善する。なお、このレーザーアニール工程は半導体層をエッチングして島状半導体層に加工してから行っても良い。

10

【0194】

後の工程は実施例13に従えば良い。なお、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例1～4で説明したそれぞれのTFT構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。また、本実施例は他の全ての実施例に示される構成との組み合わせが可能である。

【0195】

〔実施例16〕

本実施例は実施例13～15とは異なる構成を用いてアクティブマトリクス基板を作製する場合の例を示す。

20

【0196】

まず、実施例1の工程に従って形成した結晶性半導体層に対してリンの添加工程を行う。こうして n^{+} 層38、 n^{-} 層39、i層40を形成する。こうして図17（A）の状態を得たら、次に、PTFTとなる領域に対してボロンの添加工程を行い、 p^{++} 層41、 p^{-} 層42を形成する。（図17（B））

【0197】

次に、RTAによるアニールを行い、触媒元素（本実施例ではニッケル）のゲッタリング工程を行う。本実施例の特徴は、NTFTではリンによるゲッタリング効果が得られ、PTFTではリン+ボロンによるゲッタリング効果が得られる点にある。（図17（C））

30

【0198】

こうして図17（C）の状態が得られたら、レーザーアニール工程を行い、不純物添加によって非晶質化した半導体層の結晶性を改善する。なお、図17（B）に示すRTAによるゲッタリング工程が半導体層の脱水素化も兼ねている。そのため、不純物添加により膜中に多量の水素が存在したとしても水素の突沸現象は生じない。

【0199】

なお、このレーザーアニールによる再結晶化工程は半導体層をエッチングして島状半導体層に加工してから行っても良い。

【0200】

後の工程は実施例13に従えば良い。なお、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例1～4で説明したそれぞれのTFT構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。また、本実施例は他の全ての実施例に示される構成との組み合わせが可能である。

40

【0201】

〔実施例17〕

本実施例では実施例13に示した作製工程を基本として、反射型液晶表示装置を作製する場合の例を示す。ここで反射型液晶表示装置の画素マトリクス回路の任意の画素の上面図を図18（A）に示す。

【0202】

なお、実施例13で説明した部分と同じところは同一の符号を付して表し、詳細な説明は

50

省略する。また、図 14 (A) を B - B' で切断した断面図を図 18 (B) に示す。

【0203】

まず、実施例 13 と異なる点は容量配線 59 が画素内全面に広がっている点である。反射型は実施例 13 に示した様な透過型と違って、開口率を高くするという要求がないため、画素電極 61 の裏側は全て自由に使えるのである。

【0204】

また、本実施例の場合、ドレイン電極 60 をも画素内全面に広げ、可能な限り広い範囲で容量配線 59 と重畳する様に配置する。こうすることで画素内の殆どを補助容量として利用することができ、大容量を確保することができる。

【0205】

また、画素電極 61 は反射性電極であり、反射率の高いアルミニウムまたはアルミニウムを主成分とする材料を用いるのが好ましい。また、本実施例の液晶表示装置を投影型表示装置に利用するなら画素電極表面は平坦であることが好ましい。逆に直視型表示装置に用いるなら表面に凹凸をつけて乱反射率を増すなどして視野角を広げる工夫が必要である。

【0206】

なお、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例 1 ~ 4 で説明したそれぞれの TFT 構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。また、本実施例は他の全ての実施例に示される構成との組み合わせが可能である。

【0207】

〔実施例 18〕

本実施例では、実施例 13 に示した液晶表示装置における BM (ブラックマトリクス) の構成に関する説明を行う。

【0208】

まず、実施例 13 の作製工程に従って層間絶縁膜 56 の形成までを行う。本実施例では層間絶縁膜 56 として感光性を有するアクリル樹脂を用いる。そして、層間絶縁膜 56 をパターンニングした後、ハーフエッチングして凹部 65、66 を形成する。(図 19 (A))

【0209】

図 19 (A) の状態を得たら、黒色樹脂 (図示せず) を全面に形成する。黒色樹脂としてはグラファイト、カーボン、色素等を含んだ有機性樹脂膜を用いることができる。有機性樹脂膜はポリイミドやアクリル等が用いられる。本実施例ではグラファイトを分散させた感光性アクリル樹脂を利用する。

【0210】

こうして黒色樹脂を形成したら、凹部 65、66 を形成した領域のみを選択的に露光して、その部分のみに黒色樹脂を残すことが可能である。その後、酸素プラズマ雰囲気でアッシングを行い、平坦性を高めることも有効である。

【0211】

こうして黒色樹脂からなるブラックマトリクス 67、68 を形成したら、次に ITO 膜で構成される画素電極 69 を形成する。本実施例では画素電極 69 の端部とブラックマトリクス 68 の端部とが重畳する (画素電極の端面が BM より内側にある) 様に画素電極 69 をパターンニングする。

【0212】

以上の様にして図 19 (B) に示す様な構造のアクティブマトリクス基板が完成する。後は公知のセル組み工程を行えば、液晶表示装置を作製することが可能である。本実施例の様なブラックマトリクスは他の配線との間で寄生容量を形成しないという利点がある。

【0213】

なお、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例 1 ~ 4 で説明したそれぞれの TFT 構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。また、本実施例は他の全ての実施例に示される構成との組み合わせが可能である。

10

20

30

40

50

【 0 2 1 4 】

〔 実施例 1 9 〕

本実施例では実施例 1 8 とは異なるブラックマトリクスを用いた場合の例について説明する。具体的にはブラックマトリクスとして、導電性膜を用いる場合の例を示す。

【 0 2 1 5 】

図 2 0 において、5 6 は有機性樹脂膜からなる層間絶縁膜、7 1 ~ 7 4 は導電性膜からなるブラックマトリクスまたはブラックマトリクスを兼ねる配線パターンである。導電性膜としては、チタン膜、クロム膜、チタンとアルミニウムの積層膜などを用いることができる。

【 0 2 1 6 】

また、本実施例のブラックマトリクスは導電性であるため、ブラックマトリクスとしての役割以外に様々な活用方法がある。まず、7 1 で示されるパターンはコモン電位（接地電位）に固定されたブラックマトリクスである。また、7 2 で示されるパターンは C M O S 回路のドレイン電極と接続し、取り出し配線として利用される。この様に本実施例を用いれば多層配線構造が容易に実現できる。

【 0 2 1 7 】

また、7 3 で示されるパターンは C N M O S 回路のソース電極と接続しており、接続配線として機能とブラックマトリクスとしての機能とを有している。また、7 4 で示されるパターンは画素マトリクス回路に配置されるブラックマトリクスであり、基本的に配線や T F T 上に設けられる。

【 0 2 1 8 】

そして、ブラックマトリクス（またはブラックマトリクスを兼ねる配線）7 1 ~ 7 4 の上には再び層間絶縁膜 7 5 が設けられる。この層間絶縁膜 7 5 は酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、有機性樹脂膜またはそれらの積層膜で構成される。この層間絶縁膜 7 5 は後に補助容量の誘電体として機能する。

【 0 2 1 9 】

こうして層間絶縁膜 7 5 を形成したら、コンタクトホールを形成して I T O でなる画素電極 7 6 を形成する。なお、画素マトリクス回路内ではブラックマトリクス 7 4 と画素電極 7 6 との間で補助容量 7 7 が形成される。

【 0 2 2 0 】

ここで画素マトリクス回路のブラックマトリクスの配置例を図 2 1 に示す。図 2 1 は図 1 4 (A) に示される構造に対してブラックマトリクス 7 8 を重ね合わせた場合の配置例である。なお、7 9 で示される太線が画素電極、8 0 は画素電極 7 9 と下方のドレイン電極とのコンタクト部である。

【 0 2 2 1 】

ブラックマトリクス 7 8 は基本的に配線や T F T 上を覆い、映像表示領域 8 1 やコンタクト部 8 0 にのみ開口窓を有する。本実施例の様な透過型液晶表示装置においては、ブラックマトリクスの占有面積を減らし、映像表示領域 8 1 の面積を広げる（開口率を向上する）ことが最重要課題となる。

【 0 2 2 2 】

なお、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例 1 ~ 4 で説明したそれぞれの T F T 構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。また、本実施例は他の全ての実施例に示される構成との組み合わせが可能である。

【 0 2 2 3 】

〔 実施例 2 0 〕

本実施例では、実施例 1 3 に示した構造とは異なる T F T 構造でアクティブマトリクス基板を作製した場合の例を説明する。

【 0 2 2 4 】

図 2 2 に示す構造において最も重要な点は、各半導体層（ソース/ドレイン領域）の最上

10

20

30

40

50

部は第 1 の導電層 (n^+ 領域または p^{++} 領域) であり、各導電層は一旦保護膜 5 5 及び層間絶縁膜 5 6 で覆われ、その上で取り出し電極 8 1 ~ 8 5 が電氣的に接続している点にある。

【0225】

このような構造とする場合、チャネル形成領域を形成する際のチャネルエッチング工程はレジストマスクを用いて行うことになる。その上で保護膜 5 5 と層間絶縁膜 5 6 を形成して、取り出し電極 8 7 ~ 9 1 を形成する。

【0226】

本実施例の構造の様に、各取り出し電極 (ソース/ドレイン電極又は引回し配線として機能する) 8 7 ~ 9 1 を層間絶縁膜 5 6 によってゲイト電極から引き離すことでソース/ドレイン電極とゲイト電極との間の寄生容量をさらに低減することが可能である。層間絶縁膜 5 6 として、比誘電率の小さい有機性樹脂材料を用いればさらに効果的である。

【0227】

なお、本実施例の構成は、実施例 1 ~ 4 で示した T F T に対しても適用することが可能であり、無論、他の全ての実施例と組み合わせることが可能である。また、本実施例は図面に示された構造に限定されることはない。実施者は、実施例 1 ~ 4 で説明したそれぞれの T F T 構造の長所を生かして最適な構造を選択して回路設計を行えば良い。

【0228】

〔実施例 2 1〕

本実施例では、実施例 1 3 ~ 2 1 に示した構成のアクティブマトリクス基板において、外部端子との接続構造に関する説明を行う。なお、図 2 3 に示す図は外部端子 (代表的にはフレキシブルプリントサーキット (F P C)) と接続する端子部 (以下、F P C 取付け部と呼ぶ) の拡大図であってアクティブマトリクス基板の端部に位置する。

【0229】

また、図 2 3 おいて、1 0 1 はガラス基板、8 6 は絶縁層であり、実際には図 1 (A) に示される下地膜 1 0 2、窒化珪素膜 1 0 4 及び酸化窒化珪素膜 1 0 5 との積層構造で構成される。また、その上には第 2 の配線層 8 7 が形成されている。この第 2 の配線層 8 7 は外部端子からの信号をソース/ドレイン電極やゲイト電極等へ伝達するための接続配線層である。

【0230】

本実施例の特徴は、まず、第 2 の配線層 8 7 が直接ガラス基板 1 0 1 に接している点である。この構造を実現するためには、実施例 1 で説明した 3 回目のパターンニング工程において、図 2 3 に示される F P C 取付け部に存在する絶縁層 8 6 を完全に取り除く必要がある。第 2 の配線層 8 7 の下地を固いガラス基板としておくと F P C をしっかりと圧着することができる。

【0231】

また、F P C 取付け部においては、その後の工程で層間絶縁膜 5 6 も部分的に除去し、その上の I T O 膜 5 7 が第 2 の配線層 8 6 と接触する様な構造とする。この I T O 膜 5 7 は少なくとも F P C 取付け部で第 2 の配線層 8 6 上に積層されていれば良く、場合によっては電極パッドとして F P C 取付け部のみに独立のパターンとして形成しても良い。

【0232】

この I T O 膜 5 7 は後に異方性導電膜 8 8 を形成した際に異方性導電膜中に含まれる導電性粒子 (金コーティングしたシリカガラスなど) が I T O 膜にめり込みオーミック接触を良好なものとするためのバッファ層として機能する。

【0233】

そして、F P C 取付け部を図 2 3 の様な構造としたら、異方性導電膜 8 8 を用いて F P C 端子 8 9 を圧着する。こうして図 2 3 に示す様な接続構造を実現することができる。この様な接続構造を実施例 1 3 ~ 2 0 に示したアクティブマトリクス基板に適用すると外部端子との良好な電気接続が可能となる。

【0234】

10

20

30

40

50

〔実施例 2 2〕

本実施例では、大型ガラス基板上に本願発明の T F T を形成するにあたってパターニングの効率を改善するための工夫について説明する。

【0 2 3 5】

大型ガラス基板上に微細な半導体回路を作製する場合、ガラス基板の反りや縮みによるパターニング誤差が問題となる。そのため、ステッパと呼ばれる露光装置を用いた露光法が注目されている。ステッパ露光では、1枚のレチクル内のある一部のみを部分的に露光することが可能である。

【0 2 3 6】

本実施例の場合、1枚のレチクルに対してドライバー回路、画素マトリクス回路といった必要な回路パターンを部分毎に形成する。また、この時、同一構造の繰り返しとなる領域は同一回路パターンの繰り返し露光で形成する。

10

【0 2 3 7】

図 2 4 において、A、C、G、I パターンはドライバー回路の端部を作製するための回路パターンである。また、B、H パターンは水平走査用ドライバー回路の繰り返し回路パターン、D、F パターンは垂直走査用ドライバー回路の繰り返し回路パターンである。また、E パターンは画素マトリクス回路の繰り返し回路パターンである。

【0 2 3 8】

この様に、同一構造の回路が連続的に接続して構成される様なドライバー回路や画素マトリクス回路は、端部のみは専用の回路パターンで形成して、内部は完全に同一回路パターンを繰り返し利用して全体のパターン形成を行う。

20

【0 2 3 9】

この方式を用いると、回路パターンを共用できるため、1枚のレチクルに書き込む回路パターンが少なくなり、レチクルの縮小化が図れる。また、1枚のレチクルを使い回すことで、どの様な大型基板に対しても対応できるので、マスクチェンジする時間が省かれ、スループットが向上する。

【0 2 4 0】

なお、例えば画素マトリクス回路が S X G A である場合、行方向には 1280 画素が並び、列方向には 1024 画素が並ぶ。従って、前述の E パターンの行方向に 256 個分の画素に相当するパターン回路を書き込んでおけば、行方向は 5 回の繰り返し露光で終了する。また、列方向に 256 個分の画素に相当するパターン回路を書き込んでおけば、列方向は 4 回の繰り返し露光で終了する。

30

【0 2 4 1】

この様に、行方向及び列方向の繰り返し露光回数をそれぞれ n、m とし、行方向及び列方向の画素数をそれぞれ X、Y とすると、画素マトリクス回路を形成するための回路パターン内には行方向に X / n、列方向に Y / m の画素パターンを書き込んでおく必要がある。この規則性を利用すれば、A T V (アドバンスド T V) の様な 1920 x 1080 画素といった高精細なディスプレイも容易に実現することができる。

【0 2 4 2】

〔実施例 2 3〕

本実施例では実施例 1 3 ~ 2 0 に示した構成のアクティブマトリクス基板を用いて A M L C D (アクティブマトリクス型液晶表示装置) を構成した場合の例について説明する。なお、本実施例の A M L C D は駆動回路及び画素マトリクス回路を同一基板上に作製された逆スタガ型 T F T で構成している。また、駆動回路は C M O S 回路を基本として回路構成がなされているので消費電力が低い。

40

【0 2 4 3】

ここで本実施例の A M L C D の外観を図 2 5 に示す。図 2 5 (A) において、1 1 0 1 はアクティブマトリクス基板であり、その上には本願発明の T F T によって画素マトリクス回路 1 1 0 2、ソース側駆動回路 1 1 0 3、ゲイト側駆動回路 1 1 0 4 が構成されている。また、1 1 0 5 は対向基板である。

50

【 0 2 4 4 】

本実施例の A M L C D はアクティブマトリクス基板 1 1 0 1 と対向基板 1 1 0 5 とが端面を揃えて貼り合わされている。ただし、ある一部だけは対向基板 1 1 0 5 を取り除き、露出したアクティブマトリクス基板に対して F P C (フレキシブル・プリント・サーキット) 1 1 0 6 を接続してある。この F P C 1 1 0 6 によって外部信号を回路内部へと伝達する。

【 0 2 4 5 】

また、F P C 1 1 0 6 を取り付け面を利用して I C チップ 1 1 0 7、1 1 0 8 が取り付けられている。これらの I C チップはビデオ信号の処理回路、タイミングパルス発生回路、補正回路、メモリ回路、演算回路など、様々な回路をシリコン基板上に形成して構成される。図 8 では 2 個取り付けられているが、1 個でも良いし、さらに複数個であっても良い。

10

【 0 2 4 6 】

また、図 2 5 (B) の様な構成もとりうる。図 2 5 (B) において図 2 5 (A) と同一の部分は同じ符号を付してある。ここでは図 2 5 (A) で I C チップが行っていた信号処理を、同一基板上に T F T でもって形成されたロジック回路 1 1 0 9 によって行う例を示している。

【 0 2 4 7 】

この場合、ロジック回路 1 1 0 9 も駆動回路 1 1 0 3、1 1 0 4 と同様に C M O S 回路を基本として構成され、本願発明を利用した逆スタガ型 T F T で作製することが可能である。

20

【 0 2 4 8 】

また、本願発明を利用した T F T は A M L C D のスイッチング素子として以外にも、E L (エレクトロルミネッセンス) 表示装置のスイッチング素子として利用することも可能である。また、イメージセンサ等の回路を本願発明のボトムゲイト型 T F T で構成することもできる。

【 0 2 4 9 】

以上の様に、本願発明を利用した T F T でもって様々な電気光学装置を作製することが可能である。なお、本明細書中において電気光学装置とは、電気的信号を光学的信号に変換する装置またはその逆を行う装置と定義する。

30

【 0 2 5 0 】

また、本実施例の A M L C D を作製するにあたってブラックマトリクスは対向基板側に設けても良いし、アクティブマトリクス基板に設ける構成 (B M on T F T) としても良い。

【 0 2 5 1 】

また、カラーフィルターを用いてカラー表示を行っても良いし、E C B (電界制御複屈折) モード、G H (ゲストホスト) モードなどで液晶を駆動し、カラーフィルターを用いない構成としても良い。

【 0 2 5 2 】

また、特開昭 8-15686 号公報に記載された技術の様に、マイクロレンズアレイを用いる構成にしても良い。

40

【 0 2 5 3 】

〔実施例 2 4〕

実施例 2 3 に示した A M L C D は、様々な電子機器のディスプレイとして利用される。なお、本実施例に挙げる電子機器とは、A M L C D に代表される電気光学装置を搭載した製品と定義する。

【 0 2 5 4 】

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、スチルカメラ、プロジェクター、プロジェクション T V、ヘッドマウントディスプレイ、カーナビゲーション、パーソナルコンピュータ (ノート型を含む)、携帯情報端末 (モバイルコンピュータ、携帯電話等) などが挙げ

50

られる。それらの一例を図 2 6 に示す。

【 0 2 5 5 】

図 2 6 (A) は携帯電話であり、本体 2 0 0 1、音声出力部 2 0 0 2、音声入力部 2 0 0 3、表示装置 2 0 0 4、操作スイッチ 2 0 0 5、アンテナ 2 0 0 6 で構成される。本願発明は表示装置 2 0 0 4 等に適用することができる。

【 0 2 5 6 】

図 2 6 (B) はビデオカメラであり、本体 2 1 0 1、表示装置 2 1 0 2、音声入力部 2 1 0 3、操作スイッチ 2 1 0 4、バッテリー 2 1 0 5、受像部 2 1 0 6 で構成される。本願発明は表示装置 2 1 0 2 に適用することができる。

【 0 2 5 7 】

図 2 6 (C) はモバイルコンピュータ (モービルコンピュータ) であり、本体 2 2 0 1、カメラ部 2 2 0 2、受像部 2 2 0 3、操作スイッチ 2 2 0 4、表示装置 2 2 0 5 で構成される。本願発明は表示装置 2 2 0 5 等に適用できる。

【 0 2 5 8 】

図 2 6 (D) はヘッドマウントディスプレイであり、本体 2 3 0 1、表示装置 2 3 0 2、バンド部 2 3 0 3 で構成される。本発明は表示装置 2 3 0 2 に適用することができる。

【 0 2 5 9 】

図 2 6 (E) はリア型プロジェクターであり、本体 2 4 0 1、光源 2 4 0 2、表示装置 2 4 0 3、偏光ビームスプリッタ 2 4 0 4、リフレクター 2 4 0 5、2 4 0 6、スクリーン 2 4 0 7 で構成される。本発明は表示装置 2 4 0 3 に適用することができる。

【 0 2 6 0 】

図 2 6 (F) はフロント型プロジェクターであり、本体 2 5 0 1、光源 2 5 0 2、表示装置 2 5 0 3、光学系 2 5 0 4、スクリーン 2 5 0 5 で構成される。本発明は表示装置 2 5 0 3 に適用することができる。

【 0 2 6 1 】

以上の様に、本願発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、他にも電光掲示盤、宣伝広告用ディスプレイなどにも活用することができる。

【 0 2 6 2 】

〔 実施例 2 5 〕

本実施例では、本願発明の逆スタガ型 T F T を用いて構成した回路の構成例について説明する。ここではまず、シフトレジスタ回路を構成した場合の例について図 2 7 を用いて説明する。なお、本実施例では実施例 1 3 に示した構成の層構造を採用している。

【 0 2 6 3 】

また、図 2 7 (A) はシフトレジスタ回路の任意の 1 段のみを取り出した回路パターンであり、図 2 7 (B) はその等価回路図である。本実施例では図 2 7 (A) と図 2 7 (B) との位置関係が概ね対応しているので、図 2 7 (A) の説明において、必要に応じて図 2 7 (B) の符号を参照する。

【 0 2 6 4 】

図 2 7 (A) において、T F T (a) ~ T F T (d) 及び T F T (g) ~ T F T (j) で構成される回路はクロックインバータ回路、T F T (e)、T F T (g) で構成される回路はインバータ回路である。なお、T F T (e) はダブルゲイト構造の T F T を用いている。

【 0 2 6 5 】

また、1 2 0 1 は C L K 線 (クロック信号線)、1 2 0 2 は反転 C L K 線 (反転クロック信号線)、1 2 0 3 は G N D 配線 (グランド線)、1 2 0 4 は V d d 線 (電源線) である。これらの左上がりの斜線模様で示される配線は全て第 2 の配線層 (図 1 3 (A) の 4 5 ~ 5 0 で示される) である。

【 0 2 6 6 】

また、例えば 1 2 0 5 で示される配線は T F T (a) のゲイト電極として機能する。この

10

20

30

40

50

様に、右上がりの斜線模様で示される配線層は全て第1の配線層(図12(A)の32~35で示される)であり、これら第1の配線層と半導体層とが重なる部分を特にゲイト電極と呼ぶ。

【0267】

本実施例では、TF Tのソース側にはオーバーラップ領域(図中、ovと示す)を設けた構成とし、ドレイン側にはマスクオフセット領域(図中、ofと示す)を設けた構成としている。従って、図27(B)においてTF T(a)~(d)で構成されるクロックドインバータ回路を例にとると、上から順にov/of/ov/of/of/of/ov/of/ovとなる。

【0268】

即ち、TF T(a)と(b)の部分では実施例13で説明した画素TF Tのダブルゲイト構造とほぼ同じ構成となっているため、ov/of/ov/ofの様に繰り返される。また、TF T(b)と(c)の部分ではNTFTとPTFTとでドレイン電極を共通化したCMOS構造を構成しているので、実施例5で説明した様にov/of/of/ovの様な構成となる。

【0269】

他の回路も基本的には同様であり、TF T(e)はダブルゲイト構造であるのでGND線1203と接続する側から順に、ov/of/ov/ofの様な構成となる様に各TF T構造が決定されている。

【0270】

以上の様な構成によって、動作速度を落とすことなく耐圧特性を高めた信頼性の高い半導体回路を構成することができる。また、その様な半導体回路を用いることで電気光学装置の信頼性を高めることが可能である。

【0271】

〔実施例26〕

本実施例では、本願発明の逆スタガ型TF Tを用いて構成した回路の構成例について説明する。ここではまず、バッファ回路(図面左)及びアナログスイッチ回路(図面右)を構成した場合の例について図28を用いて説明する。なお、本実施例では実施例20に示した構成の層構造を採用している。また、図28(A)は回路パターンであり、図28(B)はその等価回路図である。

【0272】

図28(A)の回路パターンにおいて、TF T(a')~(h')が本願発明を利用したTF Tであり、TF T(a')、(b')及びTF T(c')、(d')でそれぞれ一つのバッファ回路を構成している。また、バッファ回路は画素マトリクス回路と同様に液晶表示装置内では最大の動作電圧で動作するので高耐圧特性が要求される。

【0273】

また、TF T(e')、(f')及びTF T(g')、(h')PTFT)のペアでそれぞれ一つのアナログスイッチ回路を構成している。アナログスイッチ回路もまた画素マトリクス回路と同様の動作電圧で動作するので高耐圧特性が要求される。

【0274】

ここでTF T(a')及び(b')で構成されるバッファ回路に注目して説明する。1301はTF T(a')のソース電極(Vdd線)、1302はTF T(b')のソース電極(GND線)、1303はTF T(a')及びTF T(b')の共通ドレイン電極(出力信号線)、1304は共通ゲイト電極(入力信号線)である。

【0275】

また、1305はドレイン領域側の第1導電層(n⁺層)、1306はソース側の第1導電層(n⁺層)、1307は薄膜化されたi層である。なお、TF T(b')の方も同様の構造であり、n⁺層の代わりにp⁺⁺層が設けられている。

【0276】

このバッファ回路は高耐圧特性を得るために実施例5に示した構成を採用している。即ち、ソース側にはオーバーラップ領域(ov)が形成され、ドレイン側にはマスクオフセット領域(of)が形成されている。こうすることでドレイン領域側のみ耐圧を高め、ソース領

10

20

30

40

50

域側は抵抗成分を減らすことができる。

【0277】

なお、この構成はTFT(c')及びTFT(d')で構成されるバッファ回路においても同様である。

【0278】

次に、TFT(e')及びTFT(f')で構成されるアナログスイッチ回路に注目して説明する。上述のバッファ回路のゲイト電極1204はTFT(e')のゲイト電極と接続し、TFT(a')及びTFT(b')の共通ドレイン電極1203はTFT(f')のゲイト電極に接続する。

【0279】

また、1208、1209はアナログスイッチ回路の共通ソース電極(入力データ信号線)であり、1209は共通ドレイン電極(出力データ信号線)である。ただし、1208はTFT(e')及びTFT(f')に対応し、1209はTFT(g')及びTFT(h')に対応する。これら1208及び1209はそれぞれ異なる映像信号を伝達する。

【0280】

この時、TFT(e')またはTFT(f')のどちらか一方がオン状態にあれば入力データ信号線1208から送られたデータ信号(映像信号)が、出力データ信号線1209を通して画素マトリクス回路へと送られる。従って、アナログスイッチ回路を構成するTFT(e')及びTFT(f')の場合にもドレイン側にはマスクオフセット領域が設けられ、ソース側にはオーバーラップ領域が設けられている。

【0281】

なお、この構成はTFT(g')及びTFT(h')で構成されるバッファ回路においても同様である。

【0282】

以上の様に、耐压特性を必要とする半導体回路に対して本願発明の構成を利用することで、信頼性の高い半導体回路を実現できる。そのことは、信頼性の高い電気光学装置を作製するためにも重要である。

【0283】

【発明の効果】

本願発明を実施することで、非常に少ないマスク数(典型的には4枚)で量産性の高いTFTを作製することができる。

【0284】

また、チャネル形成領域とソース/ドレイン電極間に、特性バラツキの小さい電界緩和層(LDD領域、マスクオフセット領域、厚さオフセット領域等)が形成できるので、信頼性が高く且つ再現性の高いTFTを実現することが可能である。

【0285】

また、その様なTFTでもって基板上に形成された半導体回路やその様な半導体回路と液晶層等を組み合わせた電気光学装置、さらには電気光学装置を表示ディスプレイとして搭載した電子機器に至るまで、本願発明はあらゆる形態の半導体装置に対して適用可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図2】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図3】 薄膜トランジスタの構成を示す拡大図。

【図4】 膜中の濃度プロファイルを示す図。

【図5】 薄膜トランジスタの構成を示す図。

【図6】 薄膜トランジスタの構成を示す図。

【図7】 薄膜トランジスタの構成を示す図。

【図8】 CMOS回路の構成を示す図。

【図9】 膜中の濃度プロファイルを示す図。

10

20

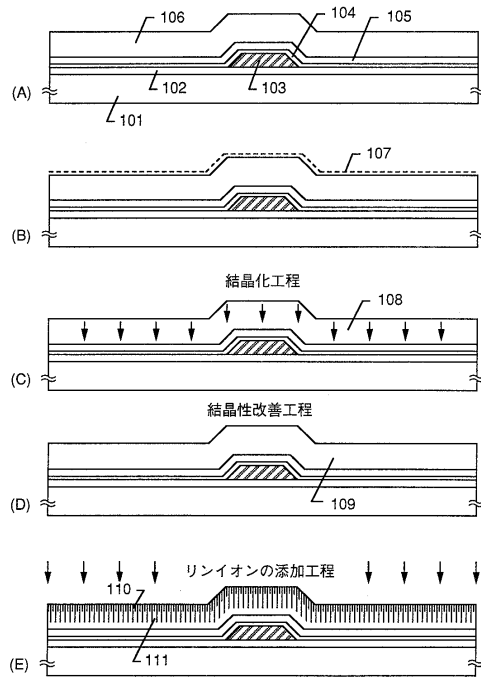
30

40

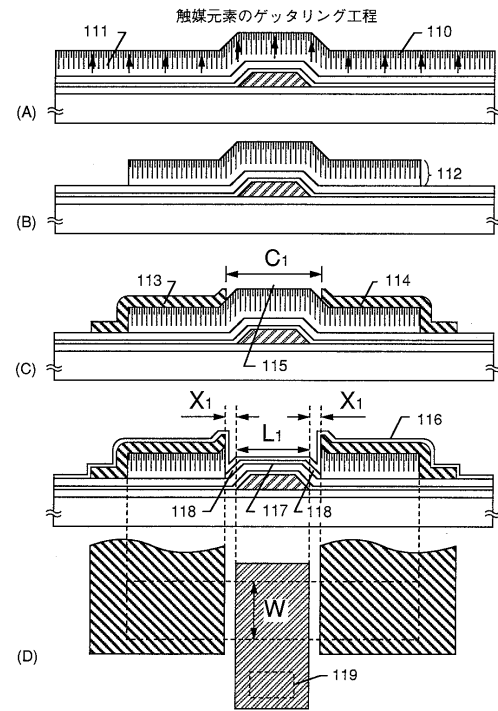
50

【図 10】	薄膜トランジスタの構成を示す図。	
【図 11】	C M O S 回路の構成を示す図。	
【図 12】	半導体回路の作製工程を示す図。	
【図 13】	半導体回路の作製工程を示す図。	
【図 14】	画素マトリクス回路の構成を示す図。	
【図 15】	半導体回路の作製工程を示す図。	
【図 16】	半導体回路の作製工程を示す図。	
【図 17】	半導体回路の作製工程を示す図。	
【図 18】	画素マトリクス回路の構成を示す図。	
【図 19】	画素 T F T の構成を示す図。	10
【図 20】	画素 T F T の構成を示す図。	
【図 21】	画素マトリクス回路の構成を示す図。	
【図 22】	画素 T F T の構成を示す図。	
【図 23】	外部端子取付け部の構成を示す図。	
【図 24】	半導体回路の露光処理方法に関する構成を示す図。	
【図 25】	電気光学装置の構成を示す図。	
【図 26】	電子機器の構成を示す図。	
【図 27】	半導体回路のパターン構成を示す図。	
【図 28】	半導体回路のパターン構成を示す図。	
【符号の説明】		20
101	基板	
102	下地膜	
103	ゲイト電極	
104	窒化珪素膜	
105	酸化窒化珪素膜	
106	非晶質半導体膜	
107	ニッケル含有層	
108	結晶性半導体膜	
109	結晶性半導体膜	
110	n^+ 層 (第 1 導電層)	30
111	n^- 層 (第 2 導電層)	
112	島状半導体層	
113	ソース電極	
114	ドレイン電極	
115	チャネルエッチング領域	
116	保護膜	
117	チャネル形成領域	
118	マスクオフセット領域	
119	コンタクトホール	

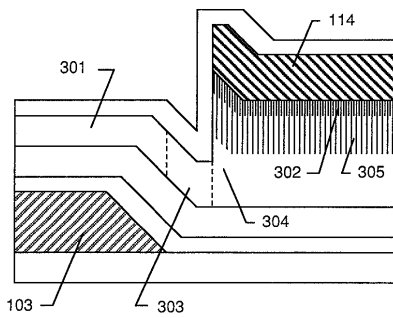
【図 1】



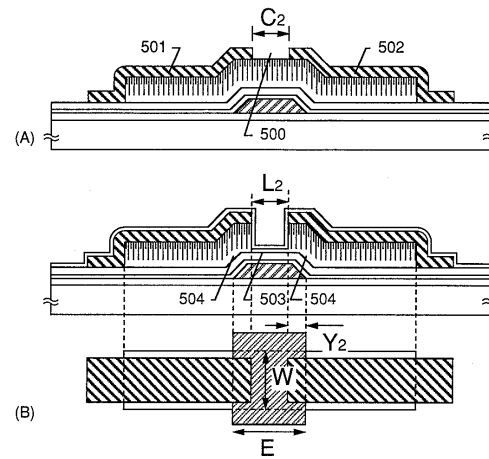
【図 2】



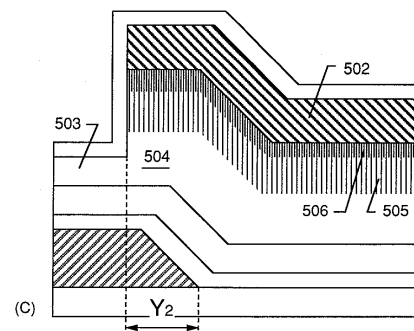
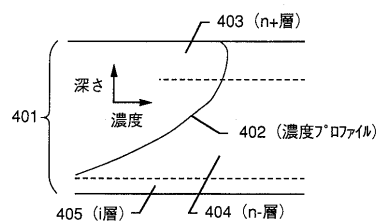
【図 3】



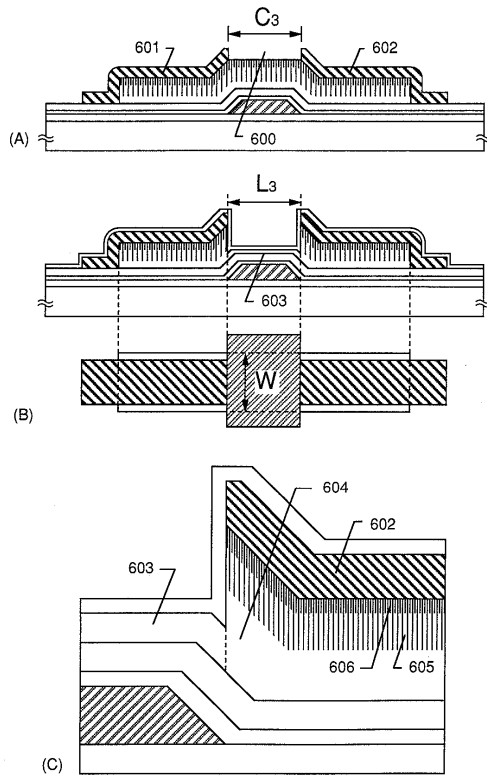
【図 5】



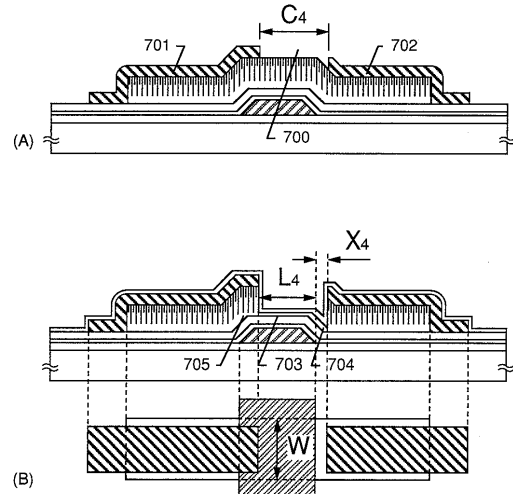
【図 4】



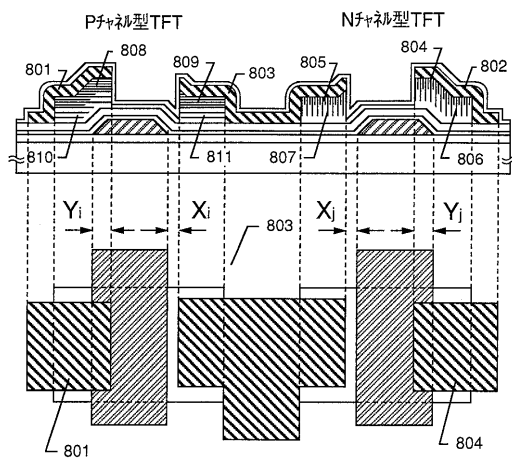
【図 6】



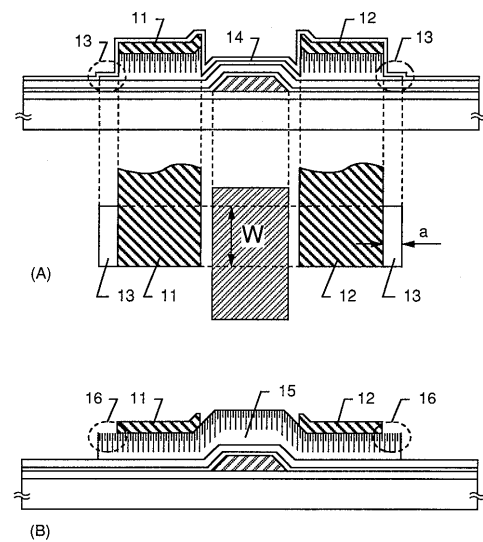
【図 7】



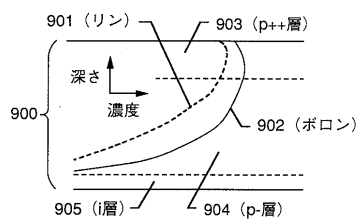
【図 8】



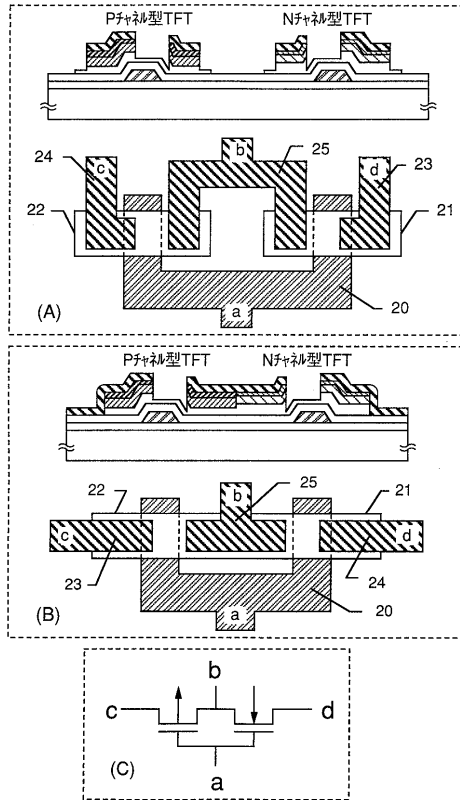
【図 10】



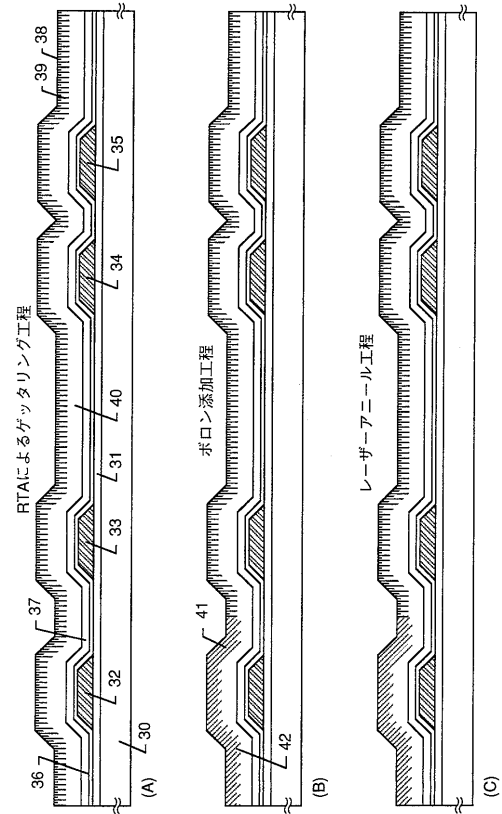
【図 9】



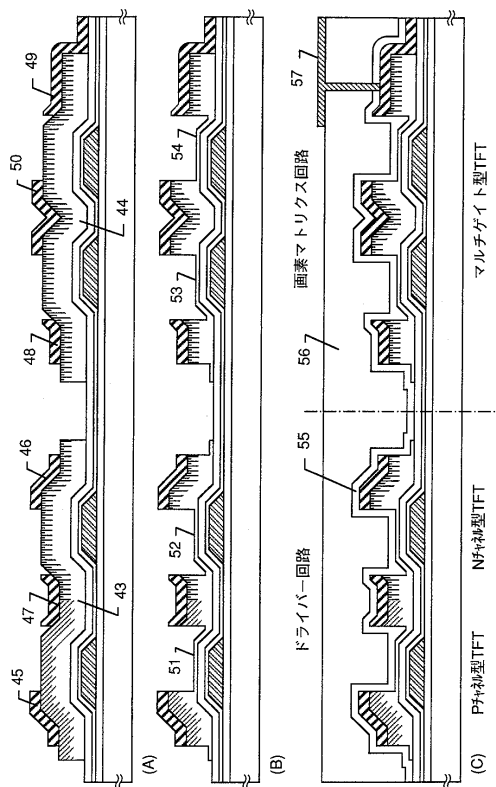
【図 1 1】



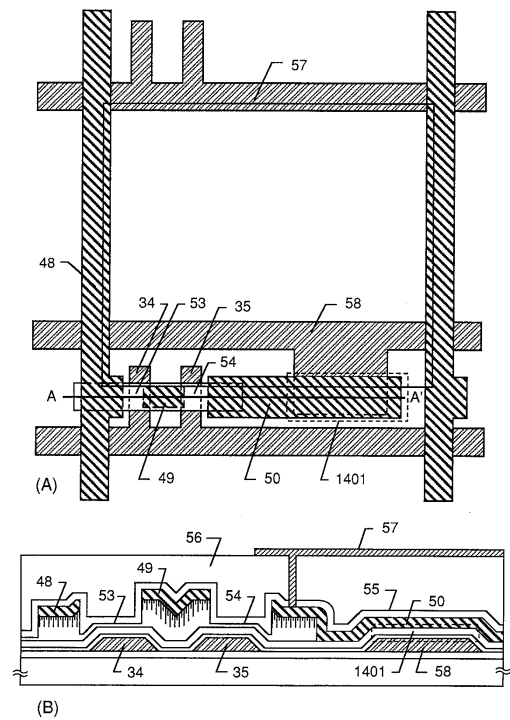
【図 1 2】



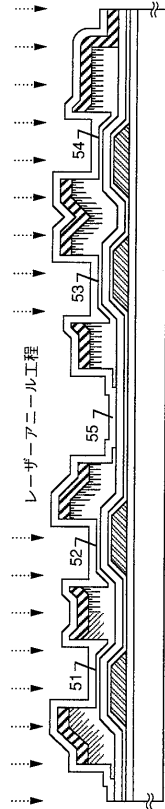
【図 1 3】



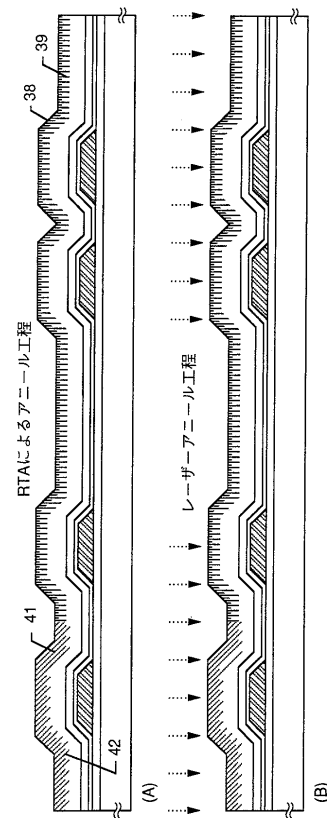
【図 1 4】



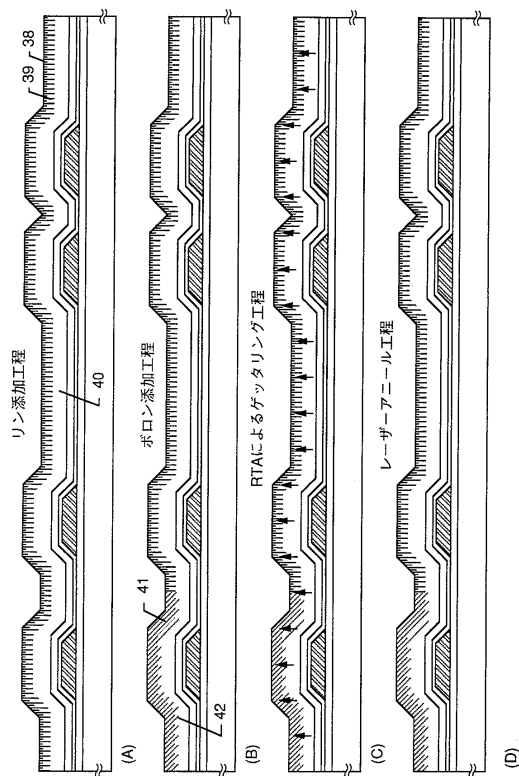
【図 15】



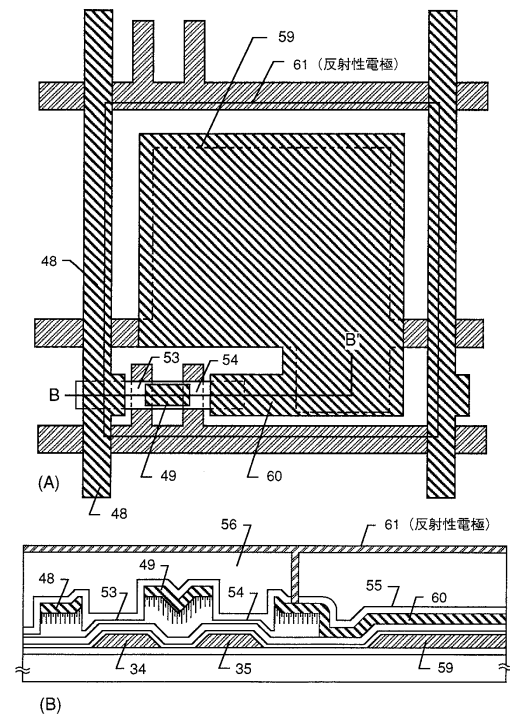
【図 16】



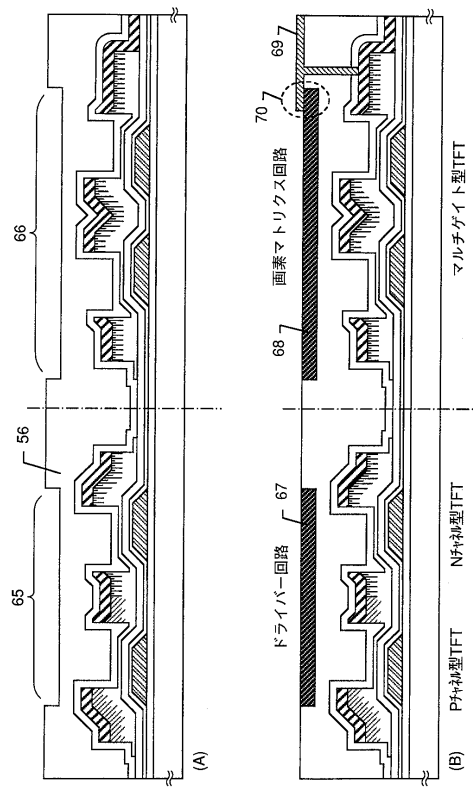
【図 17】



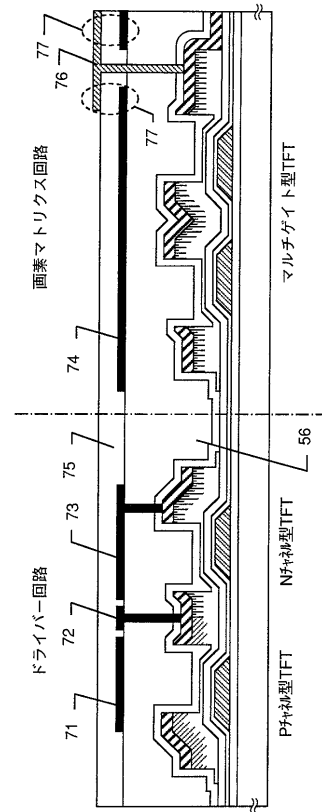
【図 18】



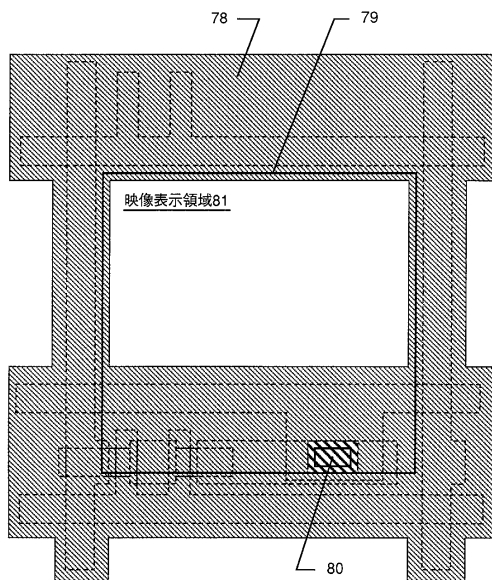
【図 19】



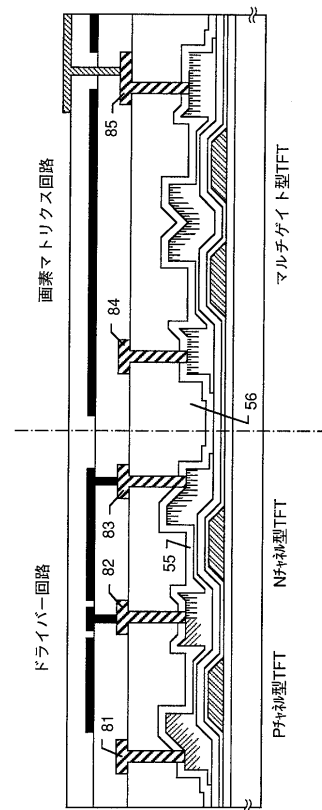
【図 20】



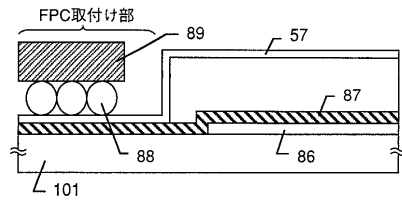
【図 21】



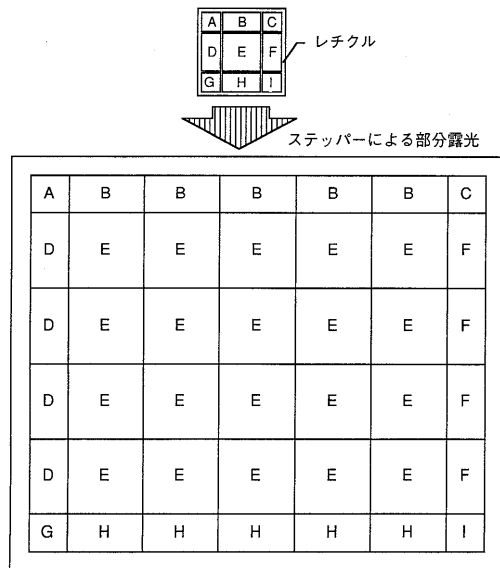
【図 22】



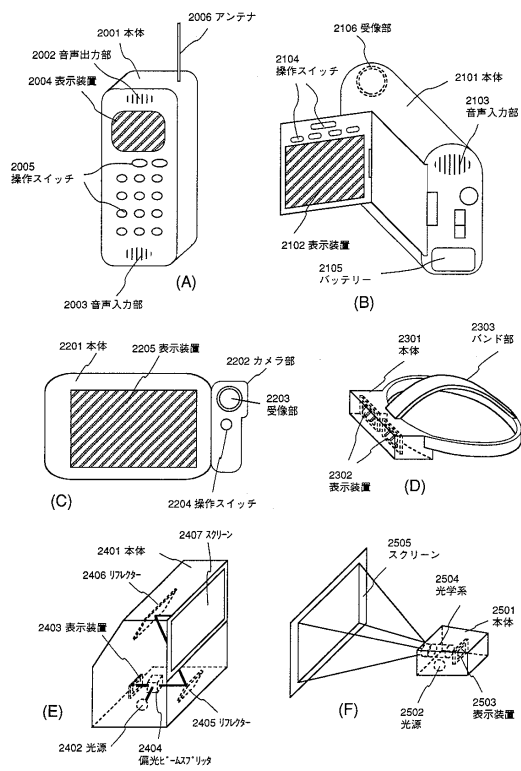
【 図 2 3 】



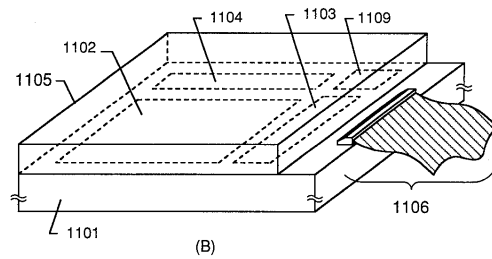
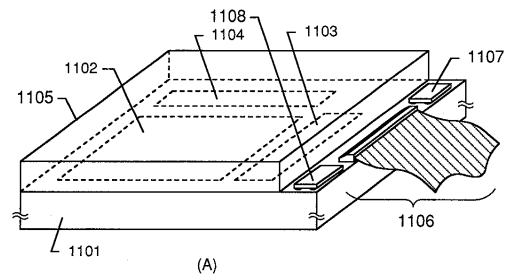
【 図 2 4 】



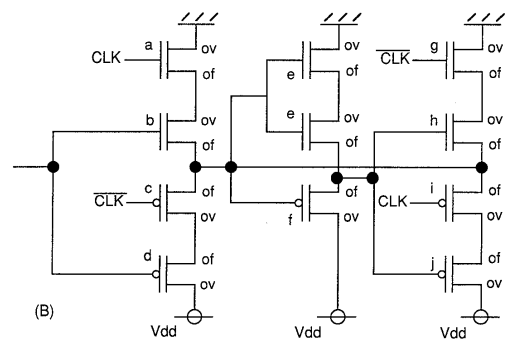
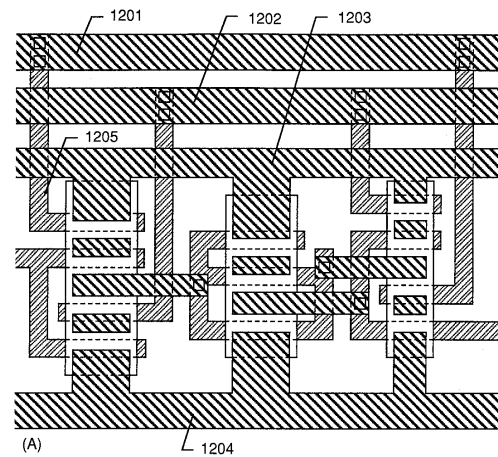
【 図 2 6 】



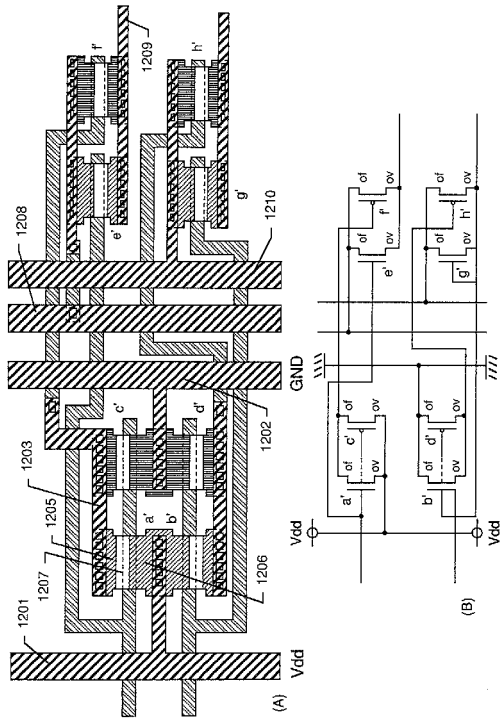
【圖 25】



【圖 27】



【図 28】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
H 0 1 L 29/78 6 2 7 G

(56)参考文献 特開平 0 5 - 3 3 5 5 8 0 (J P , A)
特開平 0 6 - 0 7 7 4 8 3 (J P , A)
特開平 0 6 - 1 1 2 4 8 6 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
H01L 29/786
H01L 21/336